

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**PRIORITY
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 06 DEC 2004

WIPO

PCT

EP04/11812

19 NOV 2004

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung****Aktenzeichen:**

103 49 750.1

Anmeldetag:

23. Oktober 2003

Anmelder/Inhaber:Commissariat à l'Energie Atomique,
Grenoble/FR; Rheinisch-Westfälisch-
Technische Hochschule Aachen, 52062
Aachen/DE.Erstanmelder: Rheinisch-Westfälisch-
Technische Hochschule Aachen, 52062
Aachen/DE**Bezeichnung:**Phasenwechselfpeicher, Phasenwechsel-
speicheranordnung, Phasenwechselspei-
cherzelle, 2D-Phasenwechselfpeicherzellen-
Array, 3D-Phasenwechselfpeicherzellen-
Array und Elektronikbaustein**IPC:**

H 01 L, G 11 C

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**München, den 04. November 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag
Schäfer

Beschreibung

Phasenwechselspeicher, Phasenwechselspeicheranordnung, Phasenwechselspeicherzelle, 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Array, 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Array und Elektronikbaustein

Die Erfindung betrifft einen Phasenwechselspeicher mit einer Speichermaterialschicht eines Phasenwechselmaterials und einem ersten und zweiten elektrischen Kontakt, die voneinander beabstandet sind und über die ein Schaltbereich der Speichermaterialschicht von einem Stromsignal durchsetzbar ist, wobei mittels dem Stromsignal ein Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase und einer amorphen Phase und damit eine Widerstandsänderung des Phasenwechselmaterials in den Schaltbereich induzierbar ist.

Die Erfindung führt auch auf eine Phasenwechselspeicheranordnung, eine Phasenwechselspeicherzelle, ein 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Array, ein 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Array und einen Elektronikbaustein.

Eines der wesentlichen Fundamente moderner Informationstechnologien sind nicht-flüchtige Speicher. In allen Datenverarbeitungs-, Datenübertragungs- und „Consumer-Electronics“-Geräten (Digitalkameras, Videokameras, Mobiltelefone, Computer etc.) werden nicht-flüchtige Speicher benötigt, um Informationen zwischenzuspeichern, oder um beim Einschalten eines Geräts wichtige Informationen für Bootvorgänge bereit zu halten. Der derzeitige Hauptvertreter für elektronische nicht-flüchtige Speicher ist das sogenannte FLASH-Memory. Zukünftige nicht-flüchtige Speicher könnten durch magnetische Speicher (MRAM) oder ferroelektrische Speicher (FRAM) oder insbesondere Phasenwechselspeicher (Phase-Change RAM / PC-RAM / PRAM / Ovonic-Unified-Memory - OUM) bereitgestellt werden.

Letztere sind Gegenstand dieser Anmeldung. Phasenwechselspeicher weisen eine Speichermaterialschicht eines Phasenwechselmaterials auf und einen ersten und zweiten elektrischen Kontakt, die von einander beabstandet sind. Über die elektrischen Kontakte ist ein Schaltbereich der Speichermaterialschicht von einem beispielsweise einen gepulsten Schaltstrom führenden Stromsignal durchsetzbar. Mittels dem Stromsignal ist ein reversibler Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase und einer amorphen Phase und damit eine Widerstandsänderung des Phasenwechselmaterials im Schaltbereich thermisch induzierbar. Bei einem dynamischen Bereich der Widerstandsänderung von bis zu drei Größenordnungen wird dies zur Bit- oder Multi-Bit-Informationsspeicherung in einem Phasenwechselspeicher genutzt. Das physikalische Prinzip eines Phasenwechselspeichers wird im Rahmen der Fig. 1 der detaillierten Beschreibung genauer erläutert.

Phasenwechselspeicher sind im Prinzip bereits seit den sechziger Jahren bekannt und beispielsweise in dem Artikel „Reversible Electrical Switching Phenomena in Disordered Structures“ von Ovshinsky in Physical Review Letters, Vol.21, Seite 1450-1453, beschrieben. Der Stand der aktuellen Technologie ist den Artikeln „OUM - A 180nm Nonvolatile Memory Cell Element Technology for Stand Alone and Embedded Applications“ von Lai und Lowrey in IEEE 2001, Seiten 36.5.1 bis 36.5.4 und „Nonvolatile, High Density, High Performance Phase-Change Memory“ von Tyson, Wicker, Lowrey, Hudgens und Hunt in IEEE 2000, Seiten 385 bis 390, zu entnehmen.

Die heutige Informations-Technologie lässt eine Konvergenz der Bereiche der kostengünstigen Massenspeicher (z. B. Festplatten und optische Datenspeicher) und schneller elektrischer Speicher (z.B. FLASH) zu sogenannten „Unified Memories“ (PC-RAM) erwarten, die eine kostengünstige Herstellung und

eine schnelle Random-Adressierung vereinen, um mit einer einzigen Technologie beide Marktsegmente zu bedienen. Die Durchsetzungsfähigkeit und das Potenzial von Phasenwechselspeichern als nicht-flüchtige Speicher in diesem Szenario hängt entscheidend davon ab, in welchem Maße sich eine Vielzahl von Phasenwechselspeichern hochintegrieren lässt. Dazu muss ein Phasenwechselspeicher mit möglichst kleinen Schaltströmen eines Stromsignals schaltbar sein, da ein Phasenwechselspeicher sonst mit zukünftigen hochintegrierten CMOS-Steuertransistoren nicht betrieben werden kann.

Das gegenwärtige Konzept eines Phasenwechselspeichers ist in der US Patentanmeldung US 5,933,365 im Detail beschrieben. Dieses Konzept basiert auf einem vertikalen Stromfluss zwischen zwei übereinander angeordneten elektrischen Kontakten des Phasenwechselspeichers. D. h. der Strom eines Stromsignals zum Schalten eines Phasenwechselspeichers der eingangs genannten Art wird senkrecht zur lateralen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers, also senkrecht zur Depositions/Lithographieebene des Phasenwechselspeichers zwischen zwei in der vertikalen Ausdehnung übereinander liegenden elektrischen Schichtkontakten geführt. Dieser „vertikale“ Aufbau für einen Phasenwechselspeicher ist nach üblicher Anschauung der zu bevorzugende, um in einem Phasenwechselspeicher-Array möglichst viele Zellen über eine Zeilen/Spalten-(X/Y)-Adressierung integrieren zu können. Ein Beispiel eines dreidimensionalen (3D)-Phasenwechselspeicher-Arrays ist in der US 6,525,953 B1 beschrieben.

Problematisch ist, dass der Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase und einer amorphen Phase im Phasenwechselmaterial über einen Strompuls des Stromsignals thermisch, z.B. unter Ausnutzung eines Temperaturbereichs zwischen Raumtemperatur und 600°C, induziert wird. Das Stromsignal wird dabei über die elektrischen, in der Regel metallischen, Kontakte dem Phasenwechselspeicher derart zugeführt, dass ein Schaltbereich einer Speichermaterialschicht von dem Stromsignal

durchsetzt wird. Da elektrische Leiter in der Regel auch gute thermische Leiter sind bedeutet dies bei den bisher üblichen Konzepten eines Phasenwechselspeichers, dass vom thermisch beeinflussten Schaltbereich zum elektrischen Kontakt hin ein hoher Energieabfluss auftritt, was wiederum eine Steigerung der Schaltströme des Stromsignals erforderlich macht.

Kleine Steuertransistoren, die jedes hochintegrierbare Speicherelement braucht, liefern in der Regel allerdings nicht genügend Strom zum Schalten eines üblichen Phasenwechselspeichers gemäß dem vertikalen Aufbau. Die in der US 5,933,365 favorisierte Lösung besteht deshalb in der Nutzung eines sogenannten „Heaters“ d. h. es wird im Rahmen des vertikalen Aufbaus jeweils zwischen einem elektrischen Kontakt und der Speichermaterialschicht eine „Heater“-Schicht angebracht, welche aus einem Material besteht, die Strom und Wärme schlechter leitet, als der elektrische Kontakt selbst. Der „Heater“ hat also eine thermisch isolierende Wirkung zwischen Speichermaterialschicht und elektrischem Kontakt. Auf diese Weise lässt sich der Schaltbereich des Phasenwechselspeichers effizienter aufheizen und im Ergebnis mit niedrigeren Schaltströmen schalten. Das heißt es lässt sich ein Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase und einer amorphen Phase und damit eine Widerstandsänderung des Phasenwechselmaterials im Schaltbereich mit geringeren Schaltströmen eines Stromsignals induzieren.

Der Effekt der in der US 5,933,365 vorgesehenen „Heater“-Schicht im Rahmen des vertikalen Aufbaus des Phasenwechselspeichers ist jedoch begrenzt und verringert den Schaltstrombedarf für ein Stromsignal nicht ausreichend, um eine ausreichend hohe Integrierbarkeit zu erreichen. Darüber hinaus wird durch die „Heater“-Schichten der Aufbau eines Phasenwechselspeichers zunehmend komplizierter.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Phasenwechselspeicher und darauf aufbauende Bauelemente anzugeben, wo-

bei der Schaltstrom eines Stromsignals und der Wärmeabfluss über die elektrischen Kontakte des Phasenwechselspeichers möglichst gering gehalten ist und gleichzeitig der strukturelle Aufbau eines Phasenwechselspeichers möglichst einfach bleiben soll.

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung mittels eines eingangs genannten Phasenwechselspeichers gelöst, bei dem erfindungsgemäß der Schaltbereich entlang einer lateralen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt angeordnet ist, wobei eine Stromführung des Stromsignals durch den Schaltbereich entlang der lateralen Ausdehnung erfolgt.

Also ist der strukturelle Aufbau des vorliegenden Phasenwechselspeichers derart, dass im Schaltbetrieb der Schaltstrom des Stromsignals lateral, also parallel zur Lithographie/Depositionsebene durch den Schaltbereich fließt. Die Stromführung des Stromsignals durch den Schaltbereich erfolgt also entlang der lateralen Ausdehnung.

Der Schaltbereich, also der Bereich innerhalb der Speichermaterialschiicht innerhalb dem mittels dem Stromsignal ein Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase und einer amorphen Phase und damit eine elektrische Widerstandsänderung des Phasenwechselmaterials induziert wird, ist also in einer Region zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt angeordnet, in der die Stromführung des Stromsignals entlang der lateralen Ausdehnung ausgerichtet ist, so dass also der Schaltbereich entlang der lateralen Ausdehnung angeordnet ist.

Die laterale Stromführung des vorliegenden Phasenwechselspeichers bildet damit die Grundlage eines völlig neuen Konzepts eines „lateralen“ Aufbaus eines Phasenwechselspeichers, der von den üblichen Ansätzen eines „vertikalen“ Aufbaus, wie sie beispielsweise in der US 5,933,365 dargestellt

sind, grundsätzlich abweicht. Üblicherweise wäre nämlich die Stromführung des Stromsignals entlang einer vertikalen Ausdehnung eines üblichen Phasenwechselspeichers, also senkrecht zur lateralen Ausdehnung, zwischen zwei in vertikaler Richtung übereinander angeordneten elektrischen Kontakten zu bevorzugen. Ein solcher „vertikaler“ Aufbau wäre auch üblicherweise als Add-On auf den CMOS-Standard grundsätzlich zu bevorzugen, da er einen platzsparenden und kompakten Aufbau ermöglicht, so dass üblicherweise eine hohe Integrationsdichte mit einem vertikalen Aufbau erreicht werden könnte.

Demgegenüber hat die vorliegende Erfindung erkannt, dass für einen Phasenwechselspeichers, zum Erreichen einer hohen Integrationsdichte, ein „lateraler“ Aufbau bzw. eine „laterales“ Konzept, das heißt eine im Schaltbereich entlang der lateralen Ausdehnung laufende Stromführung des Stromsignals und eine dem Rechnung tragender Strukturaufbau des Phasenwechselspeichers, zu bevorzugen ist. Bei einem Phasenwechselspeicher ist nämlich neben einem kompakten Aufbau die die Integrationsdichte maßgeblich begrenzende Größe der Stromverbrauch des Phasenwechselspeichers. Dieser ist bedingt durch den Schaltstrom des Stromsignals. Je geringer der Stromverbrauch eines Phasenwechselspeichers ist, desto höher läßt sich dieser integrieren, da die von den Transistoren geschalteten Schaltströme und damit auch die Transistoren selbst kleiner sein können.

Dabei ist zu beachten, dass eine stromdurchflossene Fläche eines Phasenwechselspeichers bei einem vertikalen Aufbau in der Lithographie/Depositionsebene liegt. In die stromdurchflossene Fläche eines Phasenwechselspeichers im vertikalen Aufbau, und damit in den Schaltstrom des Stromsignals, geht ausschließlich die Lithographie-Größe F (Minimum Feature Size) ein, so dass mindestens eine stromdurchflossene Fläche von F^2 und ein dementsprechend hoher Strom hingenommen werden muss.

Beim vorliegenden lateralen Aufbau des Phasenwechselfpeichers ist dies grundsätzlich anders. Vorliegend ist die stromdurchflossene Fläche senkrecht zur lateralen Ausdehnung gebildet. Bei der Stromführung des Stromsignals durch den Schaltbereich entlang der lateralen Ausdehnung, geht die Lithographie-Größe F lediglich linear in die stromdurchflossene Fläche ein. Die stromdurchflossene Fläche eines Phasenwechselfpeichers gemäß dem lateralen Aufbau ist außerdem nur noch durch die Dicke D der Speichermaterialschicht im Schaltbereich bestimmt. Die stromdurchflossene Fläche, und damit der Schaltstrom des Stromsignals, ist damit nur linear von der Lithographie-Größe F einerseits und der Schichtdicke D der Speichermaterialschicht im Schaltbereich andererseits, also durch $F \times D$, gegeben. Entsprechend gering ist der benötigte Schaltstrom des Stromsignals.

Schichtdicken D können technologisch inzwischen deutlich unter 3nm und zudem extrem genau, bis auf atomare Präzision, das heißt etwa im Bereich von 0,5 nm kontrolliert und prozessiert werden. Demgegenüber ist die Lithographie-Größe F sehr viel aufwendiger zu verringern. Derzeitige Hochtechnologiespeicher nutzen Lithographie-Größen F im Bereich von 130 nm und in Zukunft werden Lithographie-Größen F im Bereich von 45 nm angestrebt. Dem steht eine technologisch ohne Weiteres erreichbare Schichtdickengröße D im Bereich von 10-20nm, vorteilhaft unterhalb von 10nm, insbesondere unterhalb von 5nm gegenüber. Bei dem vorliegenden Phasenwechselfpeicher im lateralen Aufbau läßt sich damit die stromdurchflossenen Fläche des Schaltbereichs und damit der Schaltbereich selbst außerordentlich verkleinern im Vergleich zu einem Phasenwechselfpeicher im vertikalen Aufbau. Die stromdurchflossene Fläche im lateralen Aufbau eines Phasenwechselfpeichers, also die senkrecht zur lateralen Ausdehnung gebildete Durchtrittsfläche der Stromführung im Schaltbereich ist außerordentlich verkleinert im Vergleich zu einem Phasenwechselfpeicher im vertikalen Aufbau. Der hier

vorliegende Phasenwechselspeicher gemäß dem lateralen Aufbau wird damit immer energiesparender, hochintegrierbar und skalierbarer sein als übliche Phasenwechselspeicher.

- 5 Das Phasenwechselmaterial ist vorteilhaft ein chalkogenides Material, d.h. eine chalkogenide Legierung, also eine Legierung basierend auf den Materialien der Chalkogeniden (VI. Hauptgruppe des Periodensystems), und läßt sich prinzipiell mit Standard-Prozessen wie dem Ion-Milling, dem reaktiven Ionenätzen (Reactive Ion Etching) oder einem Plasmaätzprozess (Plasma Etching) prozessieren. Darüberhinaus ist vorliegend erkannt worden, dass ein chalkogenides Material der Speichermaterialschicht des vorliegenden Phasenwechselspeichers besonders vorteilhaft im Rahmen eines Sputter-Prozesses deponiert werden kann.

- Während bei üblichen Phasenwechselspeichern mit vertikalem Aufbau der elektrische Stromtransport und der thermische Abtransport aus dem Schaltbereich die gleiche (vertikale) Richtung haben verläuft beim hier vorliegenden Phasenwechselspeicher gemäß dem lateralen Konzept der thermische Fluss dominant in vertikaler Richtung während der elektrische Schaltstrom des Stromsignals in lateraler Richtung verläuft. Die Optimierung der Stromführung des Stromsignals im Rahmen des elektrischen Stromtransports hat unmittelbar Einfluss auf den Stromverbrauch des Phasenwechselspeichers. Die Optimierung der thermischen Umsetzung des Schaltstroms des Stromsignals im Schaltbereich hat Einfluss auf den Stromverbrauch und die Wiederbeschreibbarkeit bzw. die Geschwindigkeit eines Phasenwechselspeichers. Diese beiden wesentlichen Optimierungsparameter, elektrischer Stromverbrauch und thermischer Abtransport, werden bei dem hier vorliegenden Phasenwechselspeicher gemäß dem lateralen Konzept also unabhängig und eigenständig voneinander optimiert. Damit kann eine weitere Reduktion der Schaltströme und eine Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit des vorliegenden Phasenwechselspeichers erreicht werden.

- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen und geben im Einzelnen vorteilhafte Möglichkeiten an, den vorgeschlagenen Phasenwechselspeicher
- 5 im Rahmen des lateralen Aufbaus und Konzepts hinsichtlich Stromminimierung, gleichzeitig einfachem strukturellem Aufbau und hinsichtlich weiterer Vorteile im Einzelnen weiterzubilden.
- 10 Ein besonders bevorzugte Weiterbildung sieht vor, dass der Schaltbereich bei einer Verengung zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt in der Speichermaterialschicht angeordnet ist, wobei eine Abmessung der Verengung geringer ist, als eine Abmessung der Speichermaterialschicht am ersten
- 15 oder zweiten elektrischen Kontakt. Dabei ist die Anordnung des Schaltbereichs zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt im Wesentlichen durch die Anordnung der Verengung gegeben. Insbesondere ist der Schaltbereich durch die Verengung zwischen dem ersten und zweiten Kontakt in der
- 20 Speichermaterialschicht gebildet. Die Abmessung der Verengung kann dabei jede Abmessung einer senkrecht zur lateralen Ausdehnung gebildeten Durchtrittsfläche der Stromführung im Schaltbereich sein. Je kleiner die Verengung der Speichermaterialschicht im Schaltbereich dimensioniert werden
- 25 kann, desto geringer wird der für den thermisch induzierten Phasenwechsel und damit die Widerstandsänderung des Phasenwechselmaterials im Schaltbereich benötigte Schaltstrom des Stromsignals sein. Der wesentliche Vorteil des hier vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers liegt darin, dass die
- 30 Verengung aufgrund des lateralen Aufbaus durch die Dicke D der Speichermaterialschicht mitbestimmt ist, welche technologisch ohne Probleme weit unterhalb von 20nm, vorteilhaft unter 10nm oder 5 nm prozessiert werden kann. In der lateralen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers ist die

Verengung durch die Litographie-Größe F mitbestimmt. Dabei kann F zur Zeit ohne weiteres im Bereich von 130 nm liegen. Zukünftig werden für F Größen im Bereich von 45nm oder darunter angestrebt. Dabei gilt „Moore's Law“, d.h. die

5 Halbierung von F führt auch zu einer Halbierung von D .

Dabei erweist es sich als besonders vorteilhaft, dass eine senkrecht zur lateralen Ausdehnung gebildete Durchtrittsfläche der Stromführung im Schaltbereich im Verhältnis zu einer

10 Durchtrittsfläche der Stromführung am ersten oder zweiten elektrischen Kontakt verengt ist, wobei das Verhältnis der Durchtrittsflächen, also der Flächenkontrast, vorteilhaft zwischen 1:2 und 1:100 liegt. Eine derart starke Stromfokussierung in einen entsprechend kleinen durch die Verengung definierten Schaltbereich läßt sich vorteilhaft gemäß dem hier

15 vorgeschlagenen lateralen Aufbau und Konzept des Phasenwechselspeichers ohne weiteres erreichen. Dies führt zu einer erheblichen Stromreduktion und damit zu einer möglichen Integrationsdichte, die mit einem bisher üblichen vertikalen

20 Aufbau eines Phasenwechselspeichers nicht möglich wäre.

Die Verengung kann in der lateralen und/oder vertikalen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers realisiert sein. Insbesondere erweist es sich als vorteilhaft, dass eine Abmessung der Verengung in der lateralen Ausdehnung geringer ist, als eine Abmessung der Speichermaterialschicht in der lateralen Ausdehnung am ersten oder zweiten elektrischen Kontakt. Dabei hat sich eine doppel-kegelförmige oder H-förmige Struktur als besonders geeignet erwiesen.

30 Vorteilhafterweise kann auch eine Abmessung der Verengung in der vertikalen Ausdehnung geringer sein, als eine Abmessung der Speichermaterialschicht in der vertikalen Ausdehnung am ersten oder zweiten elektrischen Kontakt. Dies kann durch

35 eine beliebig ausgestaltete Schichtdickenverringerung der Speichermaterialschicht in einer Region zwischen dem ersten

und zweiten elektrischen Kontakt erfolgen, die dann im wesentlichen den Schaltbereich bildet.

5 Gemäß den oben aufgeführten Weiterbildungen der Erfindung wird also der Schaltbereich vorteilhaft durch eine Einschnürung oder Verengung der lateralen und/oder vertikalen Ausdehnung der Speichermaterialschicht, also im Phasenwechselmaterial selbst gebildet und angeordnet. Die höchste Stromdichte tritt damit im Schaltbereich auf und induziert
10 damit thermisch innerhalb eines durch die Lithographie-Größe F und Schichtdicke D größenordnungsmäßig bestimmten Volumens des Schaltbereichs den Phasenwechsel zwischen der kristallinen Phase und der amorphen Phase und damit die Widerstandsänderung des Phasenwechselmaterials innerhalb der Speichermaterialschicht.
15

Dies führt auf eine weitere besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung, bei der der erste und/oder der zweite elektrische Kontakt unmittelbar an die Speichermaterialschicht grenzen und der Schaltbereich beabstandet vom ersten
20 und/oder zweiten Kontakt in der Speichermaterialschicht gebildet ist.

Da die den Schaltbereich definierende Verengung im Phasenwechselmaterial der Speichermaterialschicht selbst und gleichzeitig beabstandet von den direkt an der Speichermaterialschicht angebrachten elektrischen Kontakten angeordnet ist, wirkt also das den Schaltbereich umgebende Phasenwechselmaterial in der Speichermaterialschicht thermisch isolierend zwischen dem Schaltbereich und den elektrischen Kontakten.
30 Aufgrund des lateralen Konzepts und Aufbaus des vorliegenden Phasenwechselspeichers können die hohen Temperaturen und die schnellen Temperaturänderungen des Schaltbereichs fern von den Kontaktmaterialien der elektrischen Kontakte gehalten werden.

35 Der thermische Abstand zwischen Schaltbereich und den elektrischen Kontakten ist also einerseits so groß gewählt, dass der Schaltbereich und die elektrischen Kontakte thermisch

praktisch entkoppelt sind. Dies hat den Vorteil, dass ein Energieabfluss vom Schaltbereich zum elektrischen Kontakt hin praktisch unterbunden ist, also zu einer effizienten Ausnutzung des Schaltstroms des Stromsignals hinsichtlich der thermischen Phasenumwandlung im Schaltbereich führt, weil sich dieser effizienter bis auf die Phasenwechseltemperatur aufheizen kann. Des Weiteren werden die hohen Temperaturen des Schaltbereichs fern der Kontaktmaterialien der elektrischen Kontakte gehalten, so dass eine atomare Interdiffusion der Kontaktmaterialien verhindert wird. Dadurch erweisen sich die elektrischen Kontakte, obwohl direkt an der Speichermaterialschicht angebracht, als besonders langlebig.

Zum anderen wird der thermische Abstand des Schaltbereichs zu den elektrischen Kontakten so klein gewählt, dass im Normalzustand eine möglichst gute Stromleitfähigkeit zwischen den elektrischen Kontakten gegeben ist. Es hat sich gezeigt, dass der thermische Abstand des Schaltbereichs zu einem der elektrischen Kontakte besonders vorteilhaft zwischen 20 bis 50 nm liegt. Dies garantiert eine ausreichend große Temperaturreduktion zwischen Schaltbereich und elektrischen Kontakten und erlaubt gleichzeitig eine ausreichende Stromleitfähigkeit.

Durch die hier beschriebene besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung können also übliche Kontaktmaterialien der Halbleiterindustrie Verwendung finden, wobei der vorgeschlagene Phasenwechselspeicher eine verbesserte Langzeitstabilität und eine besonders einfache Prozessführung bei der Herstellung erlaubt. Bisher übliche aufwendige Kontaktschichtsysteme zur Abschirmung oder Isolierung der elektrischen Kontakte vom Schaltbereich unter Verwendung sogenannter „Heater“-Schichten oder Diffusionsbarrieren (meistens aus TiW/Ni und Graphit) wird damit vermieden.

Bei den oben aufgeführten Weiterbildungen der Erfindung ergibt sich, dass der Schaltbereich vom Stromsignal insbeson-

dere dann entlang der lateralen Ausdehnung durchsetzt werden kann, wenn der Schaltbereich derart zwischen den elektrischen Kontakten angeordnet ist, dass wenigstens ein thermischer Abstand des Schaltbereichs zu jedem der elektrischen Kontakte
 5 im Bereich von 20 bis 50nm eingehalten werden kann. Ein Schaltbereich ist zwischen elektrischen Kontakten insbesondere dann entlang einer lateralen Ausdehnung angeordnet, wenn die Stromführung im Schaltbereich, oder gegebenenfalls darüber hinaus, wenigstens 20nm, vorteilhaft
 10 40nm, im wesentlichen parallel zur Lithographie/Depositionsebene erfolgt.

Dementsprechend muss ein Schaltbereich nicht notwendigerweise auf einer direkten Verbindungslinie zwischen einem ersten und
 15 zweiten elektrischen Kontakt angeordnet sein, sondern ausreichend ist, dass der Schaltbereich in einer Region angeordnet ist, die entlang der lateralen Ausdehnung zwischen einem ersten und zweiten elektrischen Kontakt liegt. Dabei ist vorteilhaft der erste und zweite elektrische Kontakt so ange-
 20 ordnet, dass eine Stromführung des Stromsignals durch den Schaltbereich besonders einfach entlang der lateralen Ausdehnung erfolgen kann. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist der Abstand zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt im wesentlichen entlang der lateralen Ausdehnung ausgerichtet. Dabei sollte eine Verbindungslinie zwischen den elektrischen Kontakten im wesentlichen parallel zur Lithographie/Depositionsebene verlaufen und wenn möglich nicht mehr als 45° von dieser Ebene abweichen. Im Einzelnen kann die Anordnung der elektrischen Kontakte je nach kon-
 30 struktiver Ausführung des Phasenwechselspeichers gewählt werden.

Dabei erweist es sich als besonders vorteilhaft für vielerlei Anwendungen, dass der Abstand zwischen dem ersten und zweiten
 35 elektrischen Kontakt entlang der lateralen Ausdehnung ausgerichtet ist, wobei der erste elektrische Kontakt unterhalb der Speichermaterialschicht angeordnet ist und der zweite

elektrische Kontakt oberhalb der Speichermaterialschicht angeordnet ist. Um eine Stromführung des Stromsignals durch den Schaltbereich entlang der vertikalen Ausdehnung zu vermeiden, ist dabei der erste elektrische Kontakt und der zweite elektrische Kontakt jedenfalls nicht entlang einer vertikalen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers angeordnet. Die Anordnung eines elektrischen Kontakts unterhalb der Speichermaterialschicht hat den Vorteil, dass die Kontaktierung des Phasenwechselspeichers substratseitig erfolgen kann.

Für weitere Anwendungen ist der Abstand vorteilhaft zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt entlang der lateralen Ausdehnung ausgerichtet, wobei der erste und der zweite elektrische Kontakt oberhalb der Speichermaterialschicht angeordnet sind.

Insbesondere erweist sich eine Anordnung des Schaltbereichs in einer Region zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt und unterhalb des ersten und/oder zweiten elektrischen Kontakts entlang der lateralen Ausdehnung als vorteilhaft.

Noch eine weitere besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, dass unmittelbar an die Speichermaterialschicht ein Keimbildungsbereich grenzt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass beim Schaltvorgang im Schaltbereich das Kristallisieren des amorphisierten Materials im Vergleich zur Amorphisierung der langsamere Prozess ist. Dieser kann bis zu 200ns andauern. Zum Kristallisieren bilden sich zunächst Keime, die dann wachsen bis der Schaltbereich weitgehend kristallisiert ist. Ein unmittelbar an die Speichermaterialschicht, vorzugsweise direkt an den Schaltbereich grenzender Keimbildungsbereich verkürzt jedenfalls die Keimbildung und ermöglicht es bei der vorliegenden Weiterbildung der Erfindung eine Schaltzeit jedenfalls auf bis zu 20 ns zu verkürzen.

Vorzugsweise ist der Keimbildungsbereich in Form einer Schicht ausgebildet. Das Keimbildungsmaterial kann ein auf einem Nitrid basierendes Material sein. Prozessiert wird ein Keimbildungsbereich vorzugsweise dadurch dass die

- 5 Prozessierfläche während der Deposition der Speichermaterialschicht, also z.B. der Chalkogenidschicht, kurzzeitig einer N_2 -Prozessatmosphäre ausgesetzt wird. Eine sich entlang der lateralen Ausdehnung erstreckende Keimbildungsschicht lässt sich besonders vorteilhaft im Rahmen des
- 10 hier vorgeschlagenen lateralen Konzepts eines Phasenwechselspeichers verwirklichen. Dagegen wäre dies im Rahmen eines vertikalen Aufbaus nicht möglich, da eine Nitrid-Schicht elektrisch isolierende Eigenschaften hat und jedenfalls eine vertikale Stromführung hemmt.

15

- Vorteilhaft sind bei dem vorgeschlagenen Phasenwechselspeicher der erste und zweite elektrische Kontakt und die Speichermaterialschicht Teil einer auf einem Substrat aufgetragenen MESA-Struktur wobei die Speichermaterialschicht über eine
- 20 thermische Barriere von einer Wärmesenke isoliert ist. Zwischen der Speichermaterialschicht und der thermischen Barriere kann vorteilhaft eine Keimbildungsschicht, insbesondere eine auf Nitrid-Basis, angeordnet sein. Die thermische Barriere ist vorteilhaft eine auf $ZnS:SiO_2$ -basierende Schicht. Das Phasenwechselmaterial ist vorteilhaft ein chalkogenides Material, z.B. ein $GeSbTe$ -basiertes Material. Die Wärmesenke kann durch das Substrat-Material, insbesondere ein Si-Substrat, gebildet sein. In diesem Fall wäre die Wärmesenke unterhalb des Phasenwechselspeichers angeordnet. Als
- 30 Wärmesenke kann auch eine Metallschicht dienen, die unterhalb oder oberhalb des Phasenwechselspeichers angeordnet sein kann.

- Die Erfindung führt in einer Variante auch auf eine Phasenwechselspeicheranordnung mit einem oder mehreren Phasenwechselspeichern nach einer der vorhergehenden Weiterbildungen, wobei von jedem Phasenwechselspeicher jeweils einer der elek-
- 35

trischen Kontakte mit den anderen der jeweils einen elektrischen Kontakte zusammen auf gleichem elektrischen Potenzial liegt. Das heißt jeweils ein Kontakt jedes Phasenwechselspeichers kann beispielsweise auf Masse liegen. Auf diese Weise
 5 lassen sich unterschiedlichste Anordnungen wie in der Detailbeschreibung beispielhaft erläutert realisieren.

Zur weiteren Ausgestaltung eines Phasenwechselspeichers oder einer Phasenwechselspeicheranordnung gemäß einer der erläuterten Weiterbildungen kann ein Phasenwechselspeicher außer
 10 dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt je nach Bedarf auch einen oder mehrere weitere elektrische Kontakte aufweisen.

15 Die Erfindung führt auch auf eine Phasenwechselspeicherzelle mit einem Phasenwechselspeicher gemäß einer der genannten Weiterbildungen der Erfindung und/oder einer Phasenwechselspeicheranordnung, wobei eine Selektionseinheit mit nicht-linearer Stromspannungskennlinie vorgesehen ist. Die Selektionseinheit ist aufgrund ihrer nicht-linearen Strom-Spannungskennlinie zum Ansteuern des Phasenwechselspeichers, z.B.
 20 im Rahmen eines Arrays, vorgesehen. Die Selektionseinheit kann insbesondere eine Diode oder ein Transistor sein. Bei einem Array solcher Phasenwechselspeicherzellen werden z.B. für eine X/Y-Adressierung alle Zellen einer Zeile über einen Adressierkontakt angesprochen sowie über einen weiteren Adressierkontakt alle Zellen einer Spalte. Nur die über eine bestimmte Zeile und eine bestimmte Spalte gleichzeitig angesprochene Zelle wird adressiert, da aufgrund der nicht-
 30 linearen Strom-Spannungskennlinie nur für die adressierte Zelle ein Adressiersignal (z.B. eine Spannung) oberhalb eines Thresholdsignals liegt.

Grundsätzlich kann eine Selektionseinheit extern zum Phasenwechselspeicher angeordnet sein. Es erweist sich darüber hinaus als besonders vorteilhaft, dass eine Selektionseinheit im
 35 Phasenwechselspeicher selbst und/oder in der Phasenwech-

selspeicheranordnung selbst integriert ist. Insbesondere kann eine Selektionseinheit zwischen der Speichermaterialschicht und dem ersten elektrischen Kontakt und/oder zwischen der Speichermaterialschicht und dem zweiten elektrischen Kontakt angeordnet sein. Dies ist in den Fig. 8 und 9 der Detailbeschreibung im Einzelnen erläutert. Eine solche Weiterbildung der Erfindung macht es überflüssig eine Selektionseinheit extern zum Phasenwechselspeicher zu prozessieren. Vielmehr kann diese vorteilhaft im Aufbau des Phasenwechselspeichers integriert sein. Für diese Art der Weiterbildung der Erfindung erweist sich insbesondere ein Phasenwechselspeicher als geeignet, bei dem der erste elektrische Kontakt unterhalb der Speichermaterialschicht angeordnet ist. Insbesondere für ein zweidimensionales (2D)-Phasenwechselspeicherzellen-Array eignet sich die Anordnung einer Diode als Selektionseinheit zwischen dem ersten unterhalb der Speichermaterialschicht angeordneten Kontakt und der Speichermaterialschicht. Insbesondere für ein dreidimensionales (3D)-Phasenwechselspeicherzellen-Array eignet sich die Anordnung einer Diode als Selektionseinheit zwischen dem zweiten oberhalb der Speichermaterialschicht angeordneten Kontakt und der Speichermaterialschicht.

Die Erfindung führt auch auf ein zweidimensionales (2D)-Phasenwechselspeicherzellen-Array, bei dem eine Anzahl von zweidimensional verschalteten und einzeln adressierbaren Phasenwechselspeicherzellen gemäß einer der vorhergehenden Weiterbildungen angeordnet sind.

Im Rahmen eines dreidimensionalen (3D)-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays lässt sich eine Anzahl von übereinander angeordneten Speicherschichten in Form von 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays gemäß einer der vorhergehenden Weiterbildungen der Erfindung verschalten.

Dabei erweist es sich als besonders vorteilhaft, dass jeweils direkt übereinander angeordnete Phasenwechselspeicher

und/oder Zellen über ein gemeinsames Via kontaktiert sind. Eine Kontaktierung über ein gemeinsames Via ist besonders vorteilhaft im Rahmen des vorliegenden lateralen Konzepts und Aufbaus eines Phasenwechselspeichers realisierbar, während im Rahmen eines vertikalen Aufbaus eines üblichen Phasenwechselspeichers, wie in der US 6,525,953 B1 jede Spalte und Zeile jedes Phasenwechselspeicherzellen-Arrays bei allen Speicherschichten des 3D-Arrays einzeln kontaktiert werden muss. Dagegen wird bei dem vorliegenden (3D)-Phasenwechselspeicherzellen-Array mit Phasenwechselspeichern gemäß dem lateralen Konzept und Aufbau jede Spalte und Zeile für alle Speicherschichten gemeinsam nur einmal kontaktiert.

Gemäß einer Weiterbildung des 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays nach dem lateralen Konzept und Aufbau sind zur Adressierung eines ausgewählten Phasenwechselspeichers eines 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array jeweils dazu direkt übereinander angeordnete Phasenwechselspeicherzellen über das gemeinsame Via auf ein erstes Potenzial schaltbar und dabei alle weiteren Phasenwechselspeicherzellen eines jeden weiteren 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays auf ein zweites Potenzial schaltbar. Diese Art der Verschaltung erweist sich als besonders vorteilhaft für die dreidimensionale Adressierung des vorliegenden 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays. Zum Zwecke der Zeilen/Spalten (X/Y)-Adressierung für die Ebenen können über das gemeinsame Via alle Phasenwechselspeicherzellen entlang einer Z-Richtung auf ein festes Potenzial, als erstes Potenzial, gelegt werden und so eine X/Y Auswahl getroffen werden. Die Z-Adressierung erfolgt dabei, indem beim ausgewählten 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Array alle Phasenwechselspeicherzellen auf ein freies Potenzial, als zweites Potenzial, z.B. auf Masse, gelegt werden. Die übrigen 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays befinden sich in einem „floating state / high impedance state“.

Die Erfindung führt auch auf einen Elektronikbaustein mit integrierter Speicher- und/oder Logik-Funktion, mit einem Phasenwechselspeicher und/oder einer Phasenwechselspeicheranordnung und/oder einer Phasenwechselspeicherzelle und/oder einem Phasenwechselspeicherzellen-Array nach einer der oben genannten Weiterbildungen der Erfindung. Dies kann insbesondere ein Application-Specific-Integrated-Circuit (ASIC) mit integrierter Speicher- und/oder Logik-Funktion sein. Solche Elektronikbausteine finden insbesondere Verwendung in Datenverarbeitungs-, Datenübertragungs- und „Consumer Electronics“-Geräten wie Handys, Computer sowie Video- und/oder Digitalkameras.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. Diese soll die Ausführungsbeispiele nicht notwendiger Weise maßstäblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wozu Erläuterung dienlich, in schematisierter und und/oder leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzungen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird auf den einschlägigen Stand der Technik verwiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfältige Modifikationen und Änderungen betreffend die Form und das Detail einer Ausführungsform vorgenommen werden können, ohne von der allgemeinen Idee der Erfindung abzuweichen. Die in der Beschreibung, in der Zeichnung sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Ausgestaltung der Erfindung wesentlich sein. Die allgemeine Idee der Erfindung ist nicht beschränkt auf die exakte Form oder das Detail der im folgenden gezeigten und beschriebenen bevorzugten Ausführungsform oder beschränkt auf einen Gegenstand, der eingeschränkt wäre im Vergleich zu den in den Ansprüchen im beanspruchten Gegenstand.

Die Figuren der Zeichnung zeigen im einzelnen in:

FIG 1 : eine den Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase und einer amorphen Phase und damit eine Widerstandsänderung des Phasenwechselmaterials im Schaltbereich illustrierende Widerstands-Temperatur-Grafik;

FIG 2 : ein schematisierter Aufbau eines Phasenwechselspeichers, bei dem der Schaltbereich entlang einer lateralen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers zwischen dem ersten und zweiten elektrischen Kontakt angeordnet ist, wobei eine Stromführung des Stromsignals durch den Schaltbereich entlang der lateralen Ausdehnung erfolgt;

FIG 3 : eine bevorzugte erste Ausführungsform des vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers, bei dem der erste elektrische Kontakt unterhalb der Speichermaterialschicht angeordnet ist und der zweite elektrische Kontakt oberhalb des Speichermaterialschicht angeordnet ist;

FIG 4 : eine zweite bevorzugte Ausführungsform des vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers, bei dem der erste und der zweite elektrische Kontakt oberhalb der Speichermaterialschicht angeordnet ist;

FIG 5 : eine erste schematisiert dargestellte Prozessierfolge für eine weitere bevorzugte Ausführungsform des vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers;

FIG 6 : eine zweite schematisiert dargestellte Prozessierfolge noch einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers;

FIG 7 : eine bevorzugte Ausführungsform einer Phasenwechselspeicheranordnung, bei der von jedem Phasenwechselspeicher jeweils einer der elektrischen Kontakte mit den anderen der jeweils einen elektrischen Kontakte zusammen auf gleichen elektrischen Potenzial liegt;

FIG 8 : eine schematisiert dargestellte besonders bevorzugte Ausführungsform einer Phasenwechselspeicherzelle auf einem CMOS-Steuertransistor mit Ersatzschaltbild;

FIG 9 : eine modifizierte schematisiert dargestellte besonders bevorzugte Ausführungsform einer Phasenwechselspeicherzelle, bei der eine Diode als Selektionseinheit im Phasenwechselspeicher integriert ist;

FIG 10 : ein Ersatzschaltbild für eine besonders bevorzugte Ausführungsform eines 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays;

FIG 11 : eine schematisierte Darstellung einer besonders bevorzugten Ausführungsform eines 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays mit Ersatzschaltbild;

FIG 12 : ein schematisiert dargestellter Elektronikbaustein.

Figur 1 zeigt eine mit einer Heizrate von 23°C pro Minute aufgenommene Widerstands-Temperatur-Grafik 1, die den Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase 3 und einer amorphen Phase 5 und damit eine Widerstandsänderung 7 eines Phasenwechselmaterials in einem Schaltbereich einer Speichermaterialschicht eines Phasenwechselspeichers im Prinzip

verdeutlicht. Die Widerstandsänderung 7 wird in einem
 Phasenwechselspeicher mittels einem Stromsignal über eine
 Temperaturänderung 9 thermisch induziert. Ein zu
 bevorzugendes chalkogenides Phasenwechselmaterial kann bei
 5 Raumtemperatur sowohl in einer stabilen kristallinen Phase 3
 als auch in einer metastabilen amorphen Phase 5 vorliegen.
 Die reversible Phasenumwandlung im Rahmen einer
 Amorphisierung oder Kristallisation, zwischen beiden Phasen
 5, 3 wird von einer signifikanten Änderung im elektrischen
 10 Widerstand 7 begleitet und damit zur Speicherung einer
 digitalen Information genutzt. Dabei zeigt ein
 Phasenwechselmaterial vorteilhaft einen extrem großen dy-
 namischen Bereich einer Widerstandsänderung 7, der mehr als
 drei Größenordnungen umfassen kann. Dies hat den Vorteil,
 15 dass beispielsweise auch eine Multi-Bit-Speicherung in einer
 Phasenwechselspeicherzelle möglich ist. Materialbedingt kann
 eine Phasenwechselspeicherzelle auch mit niedrigen Strömen
 ohne Zerstörung der gespeicherten Informationen gelesen wer-
 den (Non-destructive Readout). Daneben ist es auch bei dem
 20 hier vorliegenden lateralen Konzept und Aufbau eines
 Phasenwechselspeichers je nach Stromzufuhr möglich, einen
 Phasenübergang in nur einem Teil oder dem gesamten
 Schaltbereich zu bewirken, so dass damit eine mehrwertige
 Logik abhängig von der Stromzufuhr realisierbar ist. Dies
 25 kann derart erfolgen, daß z.B. bei einem ersten geringen
 Strom nur ein erster kleinerer Teil des Schaltbereichs
 phasenumgewandelt wird und bei einem zweiten höheren Strom
 ein zweiter größerer Teil des Schaltbereichs
 phasenumgewandelt wird.

30 Neben den niedrigeren Produktionskosten des hier vorgestell-
 ten lateralen Konzepts im Vergleich zum vertikalen Konzept
 erweist sich insbesondere die Integrationseigenschaft als

wesentlich besser als bei anderen Konzepten, d. h. aufgrund des geringeren Schaltstrombedarfs des hier vorliegenden Phasenwechselspeichers im lateralen Konzept werden in Zukunft höhere Integrationsdichten mit immer weniger Stromverbrauch realisierbar sein.

Die Graphik der Figur 1 zeigt eine Abfolge von quasistatischen Zuständen, sodaß die dynamischen Phasenumwandlungsprozesse einer Kristallisation 13 und einer Amorphisierung 11 immerhin im Prinzip verdeutlicht werden können. Die Prozesse sind hier jedenfalls durch entsprechende Pfeilrichtungen angedeutet. Dabei ist der Kristallisationsprozeß 13 der langsamere Prozeß. Der Amorphisierungsprozeß 11 ist dagegen der schnellere Prozeß, der nicht wirklich durch eine Abfolge von quasistatischen Zuständen beschrieben werden kann. In der Graphik ist die Amorphisierung 11 durch eine gestrichelte Linie angedeutet.

Die Figur 1 kann für den Betriebsfall eines Phasenwechselspeichers das Prinzip veranschaulichen. Im Betriebsfall liegen die Temperaturschwankungen 9 um ca. 300°C über den in der Graphik gezeigten.

Im Einzelnen wird der Phasenwechsel zwischen der kristallinen Phase 3 und der amorphen Phase 5 im Phasenwechselmaterial durch geschicktes Heizen und Abkühlen im Rahmen einer, vorteilhaft gepulsten, Schaltstromzuführung eines Stromsignals erreicht. Für die Amorphisierung 11 wird das Phasenwechselmaterial zunächst aufgeschmolzen. Durch eine schnelle Abkühlung der Schmelze erstarrt diese im amorphen Zustand 5. Eine Bedingung für die Amorphisierung 11 ist, dass die Abkühlrate von der Schmelztemperatur bis zu einer Glasktemperatur, welche

in der Regel bei ca. $2/3$ der Schmelztemperatur liegt, größer ist als die Keimbildungs- und Wachstumsrate im Temperaturbereich. Die Abkühlrate von der Glastemperatur bis zur Raumtemperatur spielt für die Amorphisierung 11 keine Rolle. Der typische Wert einer kritischen Abkühlrate liegt zwischen 10^9 bis 10^{10} K/sec . Obwohl der amorphe Zustand 5 meta-stabil ist, beträgt die Stabilitätsdauer mehr als 10 Jahre bei Raumtemperatur, was eine auch für Langzeitspeicherungen unkritische Stabilitätsdauer darstellt.

10

Die Kristallisation 13 des amorphisierten Materials 5 zum kristallinen Zustand 3 erfolgt durch Erwärmung über die Glastemperatur, wobei die maximale Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur verbleibt. In diesem Temperaturbereich ist die Keimbildungs- und Wachstumsrate maximal. Bei dem hier vorliegenden Konzept wird im Rahmen einer Ausbildungsform wie anhand der Figuren 3 und 4 erläutert, vorteilhaft ein Keimbildungsbereich unmittelbar an die Speichermaterialschicht angrenzend angeordnet, da auf diese Weise die Keimbildung verkürzt werden kann und eine Schaltzeit bei der Kristallisation auf bis zu 20ns verkürzen kann, während sonst üblicherweise Schaltzeiten im Rahmen von 200ns erreichbar sind.

Die Amorphisierung 11 und die Kristallisation 13 finden also jeweils bei einer geeigneten hohen Temperatur und mit unterschiedlicher Dynamik statt. Die Phasenumwandlungen 11, 13 in einem Phasenwechselspeicher werden bei der hier erläuterten Ausführungsform durch drei Pulse für einen Lesevorgang (Read), eine Kristallisation 13 (Set) und eine Amorphisierung 11 (Reset) genutzt.

Für die Set-Operation wird ein verhältnismäßig „langer“ Schaltstromimpuls verwendet, dessen typische Pulslängen im Bereich von 50ns liegen. Durch ohmsche Verluste steigt die Temperatur 9 im Schaltbereich über die Glastemperatur an. So
 5 lange der Puls anliegt wird der Schaltbereich kristallisiert.

Für die Reset-Operation wird der kristalline Schaltbereich durch einen verhältnismäßig „kurzen“ Puls über die Schmelztemperatur aufgeheizt, wobei typische Pulslängen unterhalb
 10 von 10ns liegen. Durch rasches Abkühlen nach Abschalten des Pulses erstarrt die Schmelze im amorphen Zustand 5.

Für die Read-Operation der gespeicherten Informationen wird eine Antwort, z.B. ein Spannungszustand, des
 15 Phasenwechselspeichers/Phasenwechselspeicherzelle auf einen schwachen Strompuls gemessen. Die Pulslänge hängt dabei nur von der Integrationszeit der Strommessstufe ab und liegt im Bereich von etwa 10ns.

20 Für weitergehende grundlegende Erläuterungen zur physikalischen Wirkungsweise eines Phasenwechselspeichers wird auf den oben erwähnten Artikel „Nonvolatile, High Density, High Performance Phase-Change Memory“ von Tyson, Wicker, Lowrey, Hudgens und Hunt in IEEE 2000, Seiten 385 bis
 25 390, verwiesen.

Figur 2 zeigt den schematisierten Aufbau eines Phasenwechselspeichers 21 mit einer Speichermaterialschicht 23 eines Phasenwechselmaterials und einem ersten elektrischen Kontakt
 30 25 und einem zweiten elektrischen Kontakt 27, die über einen Abstand 29 voneinander beabstandet sind. Über die Kontakte 25, 27 ist ein Schaltbereich 31 der Speichermaterialschicht 23 von einem Stromsignal durchsetzbar. Mittels dem

Stromsignal ist ein beispielhaft anhand der Figur 1 erläuteter Phasenwechsel 11, 13 zwischen einer kristallinen Phase 3 und einer amorphen Phase 5 und damit eine Widerstandsänderung 7 des Phasenwechselmaterials im Schaltbereich 31 mittels einer Temperaturänderung 9 thermisch induzierbar. Gemäß dem vorliegenden lateralen Konzept und Aufbau des Phasenwechselspeichers ist der Schaltbereich 31 entlang einer lateralen Ausdehnung 33 des Phasenwechselspeichers 21 zwischen dem ersten elektrischen Kontakt 25 und dem zweiten elektrischen Kontakt 27 angeordnet, wobei eine Stromführung 35 des Stromsignals durch den Schaltbereich 31 entlang der lateralen Ausdehnung 33 erfolgt.

Figur 3 zeigt eine erste bevorzugte Ausführungsform eines vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers 41. In der Ansicht (a) ist im Schnitt der Aufbau der Ausführungsform entlang einer vertikalen Ausdehnung 43 des Phasenwechselspeichers 41 gezeigt. In der Ansicht (b) ist die Ausführungsform entlang einer lateralen Ausdehnung 45 des Phasenwechselspeichers 41 gezeigt. Vorliegend ist der erste elektrische Kontakt 47 unterhalb der Speichermaterialschicht 49 angeordnet und der zweite elektrische Kontakt 51 oberhalb der Speichermaterialschicht 49 angeordnet. Bei dieser Ausführungsform des Phasenwechselspeichers 41 sind die elektrischen Kontakte 47, 51 metallisch. Der aktive Bereich des Phasenwechselspeichers 41 ist mit Siliziumoxid (SiO_2) passiviert 53. Die Speichermaterialschicht 49 besteht bei dieser Ausführungsform aus einem GeSbTe-basierten Phasenwechselmaterial. Eine darunter liegende Nitrid-Schicht 55 unterstützt die Kristallkeimbildung, um ein schnelleres und reproduzierbareres Schalten des Schaltbereichs zu ermöglichen. Eine wiederum darunter liegende $\text{ZnS}:\text{SiO}_2$ -Schicht 57 dient als einstellbare thermische Barriere und elektrische

Isolation zur Silizium-Wärmesenke 59, die bei dieser Ausführungsform durch ein p-Si-Substrat gebildet ist. Der Schaltbereich 61 ist entlang einer lateralen Ausdehnung 45 des Phasenwechselspeichers 41 zwischen dem ersten

5 elektrischen Kontakt 47 und dem zweiten elektrischen Kontakt 51 angeordnet, wobei eine Stromführung 63 des Stromsignals durch den Schaltbereich 61 entlang der lateralen Ausdehnung 45 erfolgt. Insbesondere ist bei dieser Ausführungsform der Schaltbereich 61 bei einer Verengung 65 zwischen dem ersten
10 elektrischen Kontakt 47 und dem zweiten elektrischen Kontakt 51 in der Speichermaterialschicht 49 angeordnet. Die Abmessung 67 der Verengung 65 ist dabei geringer als eine Abmessung 69 der Speichermaterialschicht 49 am ersten elektrischen Kontakt 47 oder zweiten elektrischen Kontakt 51. Die Verengung 65 ist bei dieser Ausführungsform in der lateralen Ausdehnung gebildet.
15

Figur 4 zeigt eine zweite bevorzugte Ausführungsform 71 des vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers, bei dem im

20 Unterschied zur Figur 3 der erste elektrische Kontakt 73 und der zweite elektrische Kontakt 75 oberhalb der Speichermaterialschicht 49 angeordnet sind. Der Schaltbereich 61 ist bei dieser Ausführungsform 71 in einer Region zwischen und unterhalb dem ersten elektrischen Kontakt 73 und zweiten
25 elektrischen Kontakt 75 entlang der lateralen Ausdehnung 45 angeordnet. Die Ansichten (a) und (b) der Figur 4 zeigen eine im Vergleich zur Figur 3 modifizierte Stromführung 77 des Stromsignals durch den Schaltbereich 61 entlang der lateralen Ausdehnung 45 des Phasenwechselspeichers 71. Im übrigen
30 werden für funktionsgleiche Elemente dieser Ausführungsform die gleichen Bezugszeichen wie in Figur 3 benutzt.

Sowohl in Figur 3 als auch in Figur 4 grenzt der erste elektrische Kontakt 73, 47 und/oder der zweite elektrische Kontakt 75, 51 unmittelbar an die Speichermaterialschicht 49 und der Schaltbereich 61 ist beabstandet vom ersten elektrischen Kontakt 73, 47 und/oder zweiten elektrischen Kontakt 75, 51 in der Speichermaterialschicht 49 gebildet. Der thermische Abstand 79 des Schaltbereichs 61 von den elektrischen Kontakten 73, 47 und 75, 51 beträgt vorzugsweise zwischen 20nm und 50nm.

10

In Figur 3 und Figur 4 wurden jeweils eine Verengung 65 entlang der lateralen Ausdehnung 45 gebildet. Darüber hinaus, könnte auch eine Verengung der Speichermaterialschicht 49 entlang der vertikalen Ausdehnung 43 erfolgen, was in den Figuren 3 und 4 nicht gezeigt ist, aber anhand der Figur 6 erläutert wird.

In der lateralen Ausdehnung 45 wird die Strukturgröße durch die Lithographiegröße F bestimmt, die bei derzeitiger Technologie jedenfalls in einem Bereich von etwa 45nm bis 130nm liegt, mit zukünftiger Technologie wohl auch unterhalb von 45nm. In der vertikalen Ausdehnung lässt sich der Schaltbereich bei dem hier vorliegenden lateralen Konzept eines Phasenwechselspeichers 41, 71 darüberhinaus bis auf eine Dicke D weit unterhalb von 5nm bis hin zu einer atomaren Schichtdicke von 0,5nm prozessieren. Die über die Größen $F \times D$ senkrecht zur lateralen Ausdehnung 45 gebildete Durchtrittsfläche der Stromführung 63, 77 im Schaltbereich 61 ist bei dem vorliegenden lateralen Konzept und Aufbau eines Phasenwechselspeichers 41, 71 wesentlich geringer als die durch F^2 kleinst mögliche Durchtrittsfläche der Stromführung bei einem Phasenwechselspeicher im üblichen vertikalen Aufbau. Je nach Bedarf lässt sich bei der hier erläuterten

ersten und zweiten bevorzugten Ausführungsform der Figuren 3 und 4 ein Verhältnis der Durchtrittsfläche der Stromführung 63, 77 im Schaltbereich 61 zu einer Durchtrittsfläche der Stromführung am ersten elektrischen Kontakt 47, 73 oder
 5 zweiten elektrischen Kontakt 51, 75 verengen, wobei das Verhältnis der Durchtrittsflächen vorzugsweise zwischen 1:2 und 1:100 liegt.

Figur 5 zeigt eine erste schematisiert dargestellte Prozessierfolge in drei Schritten (a), (b) und (c) für eine weitere bevorzugte Ausführungsform eines vorgeschlagenen Phasenwechselspeichers 81. Die oberen Darstellungen zeigen jeweils eine Draufsicht entlang der lateralen Ausdehnung 83. Die unteren Darstellungen zeigen jeweils eine Schnittansicht entlang der
 10 vertikalen Ausdehnung 85. Ausgangsmaterial für diese grundlegende Prozessierfolge ist ein Siliziumsubstrat 87, auf dem ein Schichtsystem als MESA-Struktur 89 mit den einzelnen Schichten in der Lithographie/Depositionsebene entlang der lateralen Ausdehnung 83 deponiert werden. Das Substrat 87
 15 dient bei dieser Ausführungsform gleichzeitig als Wärmesenke. Auf dem Substrat 87 wird zunächst ein Isolator als Wärmeleitungsschicht 91 und Isolation aufgebracht. Bei dieser Ausführungsform ist dies eine $\text{ZnS}:\text{SiO}_2$ -Schicht, wobei das Verhältnis von ZnS zu SiO_2 70:30 beträgt. Danach wird ein
 20 Phasenwechselmaterial als eine Speichermaterialschicht 93 aufgebracht. Bei dieser Ausführungsform ist das Phasenwechselmaterial ein $[\text{Sn}]:\text{GeSbTe}$ -basiertes Material. Schließlich wird eine Passivierungsschicht 95, hier aus SiO_2 , aufgebracht. Im Schritt (b) wird über einen geeigneten
 25 Litographie- und Ätzprozess eine MESA-Struktur definiert und strukturiert. Im Schritt (c) werden über einen Lithographie- und Ätzprozess Kontaktfenstern in der Passivierungsschicht 95

geöffnet und über einen Lift-Off-Prozess mit elektrischen Kontakten 97 metallisiert.

Figur 6 zeigt eine zweite schematisiert dargestellte Prozess-
 5 sierfolge in fünf Schritten (a), (b), (c), (d) und (e) noch
 einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des vorgeschlagenen
 Phasenwechselspeichers 101. Dieser ist wiederum über eine
 MESA-Struktur 103 realisiert. Die oberen Darstellungen zeigen
 jeweils eine Draufsicht entlang der lateralen Ausdehnung 83.
 10 Die unteren Darstellungen zeigen jeweils eine Schnittansicht
 entlang der vertikalen Ausdehnung 85.

Die vorliegende bevorzugte Ausführungsform des Phasenwechselspeichers 101 hat den Vorteil eines verringerten Bahnwi-
 15 derstands und einer Zellenpassivierung. Der verringerte Bahnwiderstand hat eine geringere Betriebsspannung zur Folge und die Zellenpassivierung verhindert eine Eindiffusion von umgebendem Luftsauerstoff. Ausgangspunkt bei der weiteren bevorzugten Ausführungsform der Figur 6 ist ein im Bild (a)
 20 dargestelltes modifiziertes Schichtsystem aus einem Substrat 105, einer Wärmeleitungsschicht 107, einer Speichermaterialschicht 109 und nunmehr einer elektrisch leitenden Schicht 111 als oberster Schicht.

25 Über einen geeigneten Lithographie- und Ätzprozess (b) wird zunächst eine MESA-Struktur definiert und strukturiert. Ein weiterer Lithographie- und Ätzprozess (c) definiert und strukturiert einen Graben 113 in der Region des Schaltbereichs. Der Graben 113 trennt einerseits die oberste elektrisch leitende Schicht 111 auf und definiert somit eine Po-
 30 sition der elektrischen Kontakte 115 vor. Andererseits wird durch Einstellen der Ätztiefe 117 die Dicke D des Schaltbereichs 119 eingestellt. Damit wird auch der Stromverbrauch

des Phasenwechselspeichers 101 eingestellt. Bei dieser weiteren Ausführungsform des Phasenwechselspeichers 101 der Figur 6 ist also die Dicke D der Speichermaterialschicht 109, als Abmessung einer Verengung in der vertikalen Ausdehnung 85, geringer als eine Abmessung 121 der Speichermaterialschicht 109 in der vertikalen Ausdehnung 85 an der Kontaktierung, bestehend aus den elektrischen Kontakten 115 und der aufgetrennten elektrisch leitenden Schicht 111.

10 Mit Hilfe eines geeigneten Depositionsprozesses (d) wird die bestehenden Schichtfolge mit einer Passivierung 123 versehen. In einem weiteren Schritt (e) werden über einen Lithographie- und Ätzschritt Kontaktfenster in die deponierte Passivierung 123 strukturiert und wiederum mit Hilfe eines Lift-Off-Prozesses mit elektrischen Kontakten 115 metallisiert.

Figur 7 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform einer Phasenwechselspeicheranordnung 131, die einen ersten Phasenwechselspeicher 133 einen zweiten Phasenwechselspeicher 135 und einen dritten Phasenwechselspeicher 137 miteinander verknüpft. Dabei ist von jedem Phasenwechselspeicher 133, 135, 137 jeweils einer der elektrischen Kontakte 139, 141, 143 zusammen mit den anderen der jeweils einen elektrischen Kontakte 139, 141, 143 zusammen auf gleichem elektrischen Potential gelegt, indem die elektrischen Kontakte 139, 141 und 143 auf ein allen gemeinsames Pad 145 geführt sind, das auf Masse 147 gelegt ist. Den jeweils anderen elektrischen Kontakten 149, 151, 153 ist ein jeweils schaltbares festes Potenzial über ein weiteres jeweils zugeordnetes Pad 155, 157, 159 zugeordnet.

Diese Ausführungsform einer Phasenwechselspeicheranordnung 131 ist lediglich als ein Beispiel von vielen je nach Bedarf

ausführbaren Ausführungsformen einer Phasenwechselspeicheranordnung zu verstehen.

Der Aufbau einer Phasenwechselspeicherzelle aus einem
 5 Phasenwechselspeicher oder einer Phasenwechselspeicheranordnung erfolgt gemäß der in den Figuren 8 und 9 schematisiert dargestellten Ausführungsformen im Rahmen einer CMOS-Integration von Phasenwechselspeicherzellen im lateralen Aufbau und Konzept.

10

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform einer Integration eines Phasenwechselspeichers 161 erfolgt, wie in Figur 8, gezeigt, über einen ersten elektrischen Kontakt 163 auf einem CMOS-Steuertransistor 165. Das entsprechende Ersatzschaltbild
 15 ist auf der rechten Seite der Figur 8 gezeigt. Die Phasenwechselspeicherzelle 167 der Figur 8 ist auf einem Siliziumsubstrat 169 prozessiert und im übrigen mit einer Passivierung 171 versehen. Der Steuertransistor 165 definiert bei dieser Ausführungsform über Source oder Drain eine Bit-
 20 Line BL, über sein Gate eine Word-Line WL und über Source oder Drain einen Schaltkontakt 173 zur metallischen Kontaktierung 163.

Der Phasenwechselspeicher 161 ist mit einer Passivierung 171
 25 versehen und weist einen zwischen dem ersten elektrischen Kontakt 163 und dem zweiten elektrischen Kontakt 175 beabstandet angeordneten Schaltbereich 177 in einer Speichermaterialschicht 179 auf. Bei der in Figur 8 gezeigten Ausführungsform des Phasenwechselspeichers 161 befindet sich eine
 30 Wärmesenke 181 als Metallschicht über der Speichermaterialschicht 179, wobei die Speichermaterialschicht 179 und die Wärmesenke 181 über eine Isolationsschicht 183 zur thermischen und elektrischen Isolation von der Speichermaterial-

schicht 179 isoliert ist. Die als ganzflächige Metallsierung ausgebildete Wärmesenke 181 bildet bei der hier vorliegenden Ausführungsform eines Phasenwechselspeichers 161 auch den Masseanschluss 185.

5

Figur 9 zeigt eine im Vergleich zur Figur 8 modifizierte bevorzugte Ausführungsform einer Phasenwechselspeicherzelle 187. Funktionsgleiche Elemente der Phasenwechselspeicherzelle 187 der Figur 9 und der Phasenwechselspeicherzelle 167 der Figur 8 wurden mit gleichen Bezugszeichen versehen. Bei der Ausführungsform der Phasenwechselspeicherzelle 187 ist im Unterschied zu der Ausführungsform einer Phasenwechselspeicherzelle 167 nicht ein Transistor 165 als Selektionseinheit mit nicht-linearer Stromspannungskennlinie zur Ansteuerung vor den Phasenwechselspeicher 162 geschaltet, sondern eine Diode 191. Dabei kann der obere, zweite elektrische Kontakt 175 als Word-Line und der untere, erste elektrische Kontakt 163 als Bit-Line (oder umgekehrt) direkt für eine anhand der Figuren 10 und 11 erläuterte X/Y Adressierung genutzt werden.

Die Diode 191 ist weiters im Phasenwechselspeicher 162 integriert. Bei der Phasenwechselspeicherzelle 167 der Figur 8 war der Transistor 165 als Selektionseinheit extern vor den Phasenwechselspeicher 161 geschaltet. Vorliegend ist bei der Phasenwechselspeicherzelle 187 der Figur 9 die Diode 191 zwischen der Speichermaterialschicht 179 und dem ersten elektrischen Kontakt 163 des Phasenwechselspeichers 162 angeordnet.

30

In einer Abwandlung dieser Ausführungsform könnte eine beliebige Selektionseinheit auch zwischen der Speichermaterial-

schicht 179 und dem zweiten elektrischen Kontakt 175 angeordnet sein.

Die Integration einer Selektionseinheit, vorliegend einer Diode 191, hat den Vorteil, dass dies die Prozessierung einer Phasenwechselspeicherzelle 187 erheblich vereinfacht und zudem aufgrund des verringerten Raumbedarfs die Integrationsdichte für eine Phasenwechselspeicherzelle 187 erheblich erhöht.

Für zukünftige Speicherkonzepte wird der Kostenfaktor „bit per area ratio“ eine dominante Rolle spielen. Überlegungen, die eigentlichen Phasenwechselspeicherzellen übereinander zu „stapeln“ und damit dreidimensionale 3D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Arrays zu bilden sind in diesem Zusammenhang sehr reizvoll. Vorliegend bietet der laterale Aufbau und das laterale Konzept eines hier erläuterten Phasenwechselspeichers einen für diese Art der Integration entscheidenden Vorteil gegenüber dem vertikalen Aufbau eines üblichen Phasenwechselspeichers.

Der Aufbau eines 3D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Arrays erfolgt mit einer Anzahl von übereinander angeordneten Speicherschichten in Form von 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Arrays. Ein 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array 201 ist in Figur 10 im Detail (a) und als Ersatzschaltbild (b) gezeigt. Das 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array 201 umfasst eine Anzahl von zweidimensional im Rahmen einer Zeilen/Spalten (x/y)-Adressierung verschalteten und einzeln adressierbaren Phasenwechselspeicherzellen 203. Jede der Phasenwechselspeicherzellen 203 ist vorliegend jeweils aus einem Transistor 205 und einem Phasenwechselspeicher 207 aufgebaut. Bevorzugt wird anstatt eines Transistors eine

Diode verwendet. Ein in Figur 11 gezeigtes 3D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array 211 ist in seinem dreidimensionalen Aufbau (a) und als Ersatzschaltbild (b) gezeigt. Es weist eine Anzahl von übereinander angeordneten 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Arrays 213 auf. Dabei sind jeweils direkt übereinander angeordnete Phasenwechselspeicher 215 von einem Auswahltransistor 217 über ein gemeinsames Via 219 angesteuert und kontaktiert. Eine solche Integration ist bei einem Phasenwechselspeicher im vertikalen Aufbau nur bedingt möglich und bisher nicht realisiert, da ein gemeinsames Via nicht oder nur unter zusätzlichem Platzaufwand realisiert werden kann. Vielmehr ist, wie in der US 6,525,953 B1 beschrieben, ein übliches 3D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array auf die separate Kontaktierung jedes einzelnen Zeilen- und Spaltenkontaktes (entsprechend als Word- oder Bit-Line oder umgekehrt) bei allen Speicherschichten angewiesen.

Dagegen erfolgt bei der vorliegenden Ausführungsform eines 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays 211 der Figur 11 die Schaltung von jeweils direkt übereinander angeordneten Phasenwechselspeichern 215 über das gemeinsame Via 219 auf ein erstes festes Potential. Auf diese Weise erfolgt die Zeilen/Spalten (x/y) Adressierung für die Ebenen. Alle übereinander liegenden Phasenwechselspeicher 215 entlang einer Z-Richtung liegen somit auf dem durch das Via 219 vorgegebenen festen ersten Potenzial. Die Z-Adressierung, beispielsweise die Auswahl der unteren Phasenwechselspeicherzelle 215 in der Ausführungsform 211 der Figur 11, erfolgt bei dieser Ausführungsform indem alle anderen Phasenwechselspeicherzellen der weiteren 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Arrays auf ein zweites, freies, z. B. Massepotenzial 221 gelegt werden.

Figur 12 zeigt einen Elektronikbaustein 225 (Embedded Device , z.B. ASICS), der eine integrierte Speicher- 227 und/oder Logikfunktion 223 vereinigt. Dabei weist die integrierte Speicher- 227 und/oder Logikfunktion 223 einen Pha-
 5 senwechspeicher, eine Phasenwechspeicheranordnung, eine Phasenwechspeicherzelle oder ein Phasenwechspeicher- Zellen-Array der oben beschriebenen Art auf.

Zusammenfassend ist die Stromflussbegrenzung zum Schalten ei-
 10 nes Phasenwechspeichers (PC-RAM) ein wesentliches Problem bei Phasenwechspeichern bekannter Art. Dabei basieren alle bisherigen Konzepte zur Realisierung eines Phasenwechspeichers auf einer vertikalen Stromführung, die senkrecht zur lateralen Ausdehnung des Phasenwechspeichers zwischen zwei
 15 übereinander liegenden elektrischen Kontakten erfolgt. Bekannte Phasenwechspeicher sind also für eine zur Lithographie/Depositionsebene vertikale Stromführung ausgelegt.

Eine besonders effiziente Strombegrenzung wird erreicht bei einem Phasenwechspeicher 21, 41, 71, 81, 101, 161, 162,
 20 215 mit einer Speichermaterialschicht 23, 49, 93, 109, 179 eines Phasenwechspeichermaterials, und einem ersten 25, 47, 73, 97, 115 und zweiten 27, 51, 75, 97, 115 elektrischen Kontakt, die von einander beabstandet sind und über die ein Schaltbereich 31, 61, 119, 177 der Speichermaterialschicht
 25 23, 49, 93, 109, 179 von einem Stromsignal durchsetzbar ist, wobei mittels dem Stromsignal ein Phasenwechsel 11, 13 zwischen einer kristallinen Phase 3 und einer amorphen Phase 5 und damit eine Widerstandsänderung 7 des Phasenwechspeichermaterials im Schaltbereich 31, 61, 119, 177 in-
 30 duzierbar ist. Bei einem solchen Phasenwechspeicher ist im Rahmen des neuen Konzepts vorgesehen, dass der Schaltbereich 31, 61, 119, 177 entlang einer lateralen Ausdehnung 33, 45, 83 des Phasenwechspeichers zwischen dem ersten 25, 47, 73,

97, 115 und zweiten 27, 51, 75, 97, 115 elektrischen Kontakt angeordnet ist, wobei eine Stromführung 35, 63, 77 des Stromsignals durch den Schaltbereich 31, 61, 119, 177 entlang der lateralen Ausdehnung 33, 45, 83 erfolgt. Unter anderem
5 lässt sich auf diese Weise eine senkrecht zur lateralen Ausdehnung gebildete Durchtrittsfläche der Stromführung 35, 63, 77 erheblich verringern, so dass der für ein Stromsignal benötigte Schaltstrom erheblich verringert ist.

10 Das neue Konzept führt auch auf eine Phasenwechselspeicheranordnung 131, eine Phasenwechselspeicherzelle 167, 187, 203, ein 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Array 201, 213, ein 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Array 211 und einen Elektronikbaustein 225.

Patentansprüche

1. Phasenwechselspeicher (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215)
 mit einer Speichermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179)
 5 eines Phasenwechselmaterials, und einem ersten (25, 47,
 73, 97, 115) und zweiten (27, 51, 75, 97, 115)
 elektrischen Kontakt, die von einander beabstandet sind
 und über die ein Schaltbereich (31, 61, 119, 177) der
 Speichermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179) von einem
 10 Stromsignal durchsetzbar ist, wobei mittels dem
 Stromsignal ein Phasenwechsel (11, 13) zwischen einer
 kristallinen Phase (3) und einer amorphen Phase (5) und
 damit eine Widerstandsänderung (7) des
 Phasenwechselmaterials im Schaltbereich (31, 61, 119, 177)
 15 induzierbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Schaltbereich (31, 61, 119, 177) entlang einer lateralen
 20 Ausdehnung (33, 45, 83) des Phasenwechselspeichers zwischen
 dem ersten (25, 47, 73, 97, 115) und zweiten (27, 51, 75, 97,
 115) elektrischen Kontakt angeordnet ist, wobei eine
 Stromführung (35, 63, 77) des Stromsignals durch den
 Schaltbereich (31, 61, 119, 177) entlang der lateralen
 25 Ausdehnung (33, 45, 83) erfolgt.

2. Phasenwechselspeicher (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215)
 nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

30 der Schaltbereich (31, 61, 119, 177) bei einer Verengung (65)
 zwischen dem ersten (25, 47, 73, 97, 115) und zweiten (27,
 51, 75, 97, 115) elektrischen Kontakt in der
 Speichermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179) angeordnet

ist, wobei eine Abmessung (67, D) der Verengung (65) geringer ist, als eine Abmessung (69, 121) der Speichermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179) am ersten (25, 47, 73, 97, 115) oder zweiten (27, 51, 75, 97, 115) elektrischen Kontakt.

5

3. Phasenwechselspeicher (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215) nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine senkrecht zur lateralen Ausdehnung gebildete Durchtrittsfläche der Stromführung (35, 63, 77) im Schaltbereich (31, 61, 119, 177) im Verhältnis zu einer Durchtrittsfläche der Stromführung (35, 63, 77) am ersten (25, 47, 73, 97, 115) oder zweiten (27, 51, 75, 97, 115) elektrischen Kontakt verengt ist, wobei das Verhältnis der Durchtrittsflächen zwischen 1:2 und 1:100 liegt.

4. Phasenwechselspeicher (41, 71) nach Anspruch 2 oder 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine Abmessung (67) der Verengung (65) in der lateralen Ausdehnung (45) geringer ist, als eine Abmessung (69) der Speichermaterialschicht (49) in der lateralen Ausdehnung (45) am ersten (47, 49) oder zweiten (51, 75) elektrischen Kontakt.

5. Phasenwechselspeicher (101) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine Abmessung (D) der Verengung in der vertikalen Ausdehnung (85) geringer ist, als eine Abmessung (121) der Speichermaterialschicht (109) in der vertikalen Ausdehnung (85) am ersten oder zweiten elektrischen Kontakt (115).

6. Phasenwechselspeicher (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
der erste (25, 47, 73, 97, 115) und/oder der zweite (27, 51,
5 75, 97, 115) elektrische Kontakt unmittelbar an die Spei-
chermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179) grenzen und der
Schaltbereich (31, 61, 119, 177) beabstandet (79) vom ersten
(25, 47, 73, 97, 115) und/oder zweiten (27, 51, 75, 97, 115)
Kontakt in der Speichermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179)
10 gebildet ist.

7. Phasenwechselspeicher (41, 161, 162, 215) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n
e t, dass der Abstand zwischen dem ersten (47, 163) und
15 zweiten (51, 175) elektrischen Kontakt entlang der
lateralen Ausdehnung (45) ausgerichtet ist, wobei der
erste elektrische Kontakt (47, 163) unterhalb der
Speichermaterialschicht (49, 179) angeordnet ist und der
zweite elektrische Kontakt (51, 175) oberhalb der
20 Speichermaterialschicht (49, 179) angeordnet ist.

8. Phasenwechselspeicher (71, 81, 101) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
25 der Abstand zwischen dem ersten (73, 97, 115) und zweiten
(75, 97, 115) elektrischen Kontakt entlang der lateralen
Ausdehnung (83) ausgerichtet ist, wobei der erste (73, 97,
115) und der zweite (75, 97, 115) elektrische Kontakt
oberhalb der Speichermaterialschicht (93, 109) angeordnet
30 sind.

9. Phasenwechselspeicher (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215)
nach Anspruch 7 oder 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c

h n e t, dass der Schaltbereich (31, 61, 119, 177) in einer Region zwischen dem ersten (25, 47, 73, 97, 115) und zweiten (27, 51, 75, 97, 115) elektrischen Kontakt und unterhalb des ersten (25, 47, 73, 97, 115) und/oder zweiten (27, 51, 75, 97, 115) elektrischen Kontakts entlang der lateralen Ausdehnung (33, 45, 83) angeordnet ist.

10. Phasenwechselspeicher (41, 71) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass unmittelbar an die Speichermaterialschicht (49) ein Keimbildungsbereich (55) grenzt.

11. Phasenwechselspeicher (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der erste (25, 47, 73, 97, 115) und zweite (27, 51, 75, 97, 115) elektrische Kontakt und die Speichermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179) Teil einer auf einem Substrat (87, 105, 169) aufgebrachten MESA-Struktur (89, 103) sind, wobei die Speichermaterialschicht (23, 49, 93, 109, 179) über eine thermische Barriere (91, 107, 183) von einer Wärmesenke (87, 105, 181) isoliert ist.

12. Phasenwechselspeicheranordnung (131) mit einem oder mehreren Phasenwechselspeichern (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass von jedem Phasenwechselspeicher (133, 135, 137) jeweils einer der elektrischen Kontakte (139, 141, 143) mit den anderen der jeweils einen elektrischen Kontakte (139, 141, 143) zusammen auf gleichem elektrischen Potenzial (147) liegt.

13. Phasenwechselspeicherzelle (167, 187, 203) mit einem Phasenwechselspeicher (21, 41, 71, 81, 101, 161, 162, 215) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 und/oder einer Phasenwechselspeicheranordnung (131) nach Anspruch 12 g e k e n n z e i c h n e t d u r c h eine Selektionseinheit (165, 191) mit nicht-linearer Strom-Spannungs-Kennlinie.

14. Phasenwechselspeicherzelle (167, 187, 203) nach Anspruch 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Selektionseinheit (165, 191) im Phasenwechselspeicher (162) und/oder der Phasenwechselspeicheranordnung integriert ist.

15. Phasenwechselspeicherzelle (167, 187, 203) nach Anspruch 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Selektionseinheit (165, 191) zwischen der Speichermaterialschicht (179) und dem ersten elektrischen Kontakt (163) und/oder zwischen der Speichermaterialschicht (179) und dem zweiten elektrischen Kontakt (175) im Phasenwechselspeicher (162) angeordnet ist.

16. 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array (201, 213) g e k e n n z e i c h n e t d u r c h eine Anzahl von zweidimensional verschalteten und einzeln adressierbaren Phasenwechselspeicherzellen ((167, 187, 203)) nach einem der Ansprüche 13 bis 15.

17. 3D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array (211) mit einer Anzahl von übereinander angeordneten 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Arrays (201, 213) nach Anspruch 16, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass jeweils direkt übereinander angeordnete Phasenwechselspeicher (215) über ein gemeinsames Via (219) kontaktiert sind.

18. 3D-Phasenwechselspeicherzellen-Array (211) nach Anspruch
17, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t d a s s z u r
Adressierung eines ausgewählten Phasenwechselspeichers
5 (215) eines 2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Arrays (213)
jeweils dazu direkt übereinander angeordnete Phasenwech-
selspeicher (215) über das gemeinsame Via (219) auf ein
erstes Potenzial schaltbar sind und dabei alle weiteren
Phasenwechselspeicherzellen eines jeden weiteren 2D-
10 Phasenwechselspeicherzellen-Arrays (213) auf ein zweites
Potenzial (221) schaltbar sind.

19. Elektronikbaustein (225) mit einem anwendungsbezogenen
Baustein (227) und integrierter Speicher- und/oder Logik-
15 Funktion (223), mit einem Phasenwechselspeicher (21, 41, 71,
81, 101, 161, 162, 215) nach einem der Ansprüche 1 bis 11
und/oder einer Phasenwechselspeicheranordnung (131) nach
Anspruch 12 und/oder einer Phasenwechselspeicherzelle (167,
187, 203) nach einem der Ansprüche 13 bis 15 und/oder einem
20 Phasenwechselspeicherzellen-Array (201, 213, 211) nach einem
der Ansprüche 16 bis 18.

Zusammenfassung

Die Stromflussbegrenzung zum Schalten eines Phasenwech-
selspeichers (PC-RAM) ist ein wesentliches Problem bei Pha-
5 senwechselspeichern bekannter Art. Deren Aufbau basiert auf
einer vertikalen Stromführung, die senkrecht zur lateralen
Ausdehnung des Phasenwechselspeichers zwischen zwei überein-
ander liegenden elektrischen Kontakten erfolgt, basiert.

10 Eine besonders effiziente Strombegrenzung wird erreicht bei
einem Phasenwechselspeicher mit einer Speichermaterialschicht
eines Phasenwechselmaterials und einem ersten und zweiten
elektrischen Kontakt, die voneinander beabstandet sind und
über die ein Schaltbereich der Speichermaterialschicht von
einem Stromsignal durchsetzbar ist, wobei mittels dem Strom-
15 signal ein Phasenwechsel zwischen einer kristallinen Phase
und einer amorphen Phase und damit eine Widerstandsänderung
des Phasenwechselmaterials im Schaltbereich induzierbar ist.
Im Rahmen des neuen Konzepts ist bei einem solchen Phasen-
wechselspeicher vorgesehen, dass der Schaltbereich entlang
20 einer lateralen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers zwi-
schen dem ersten und dem zweiten elektrischen Kontakt ange-
ordnet ist, wobei eine Stromführung des Stromsignals durch
den Schaltbereich entlang der lateralen Ausdehnung erfolgt.
Unter anderem lässt sich auf diese Weise eine senkrecht zur
lateralen Ausdehnung gebildete Durchtrittsfläche der Strom-
führung und damit der für ein Stromsignal benötigte Schalt-
strom erheblich verringern. Die Erfindung führt auch auf eine
Phasenwechselspeicheranordnung, eine Phasenwechselspeicher-
zelle, ein 2D-Phasenwechselspeicherzellen-Array, ein 3D-Pha-
30 senwechselspeicherzellen-Array und einen anwendungsbezogener
Baustein mit integrierter Speicher- und/oder Logik-Funktion.

Bezugszeichenliste

	1	Widerstands-Temperatur-Grafik
	3	kristalline Phase
5	5	amorphe Phase
	7	Widerstandsänderung
	9	Temperaturänderung
	11	Amorphisierung
	13	Kristallisation
10	21	Phasenwechselspeicher
	23	Speichermaterialschicht
	25	erster elektrischer Kontakt
	27	zweiter elektrischer Kontakt
	29	Abstand
15	31	Schaltbereich
	33	laterale Ausdehnung
	35	Stromführung
	41	erste bevorzugte Ausführungsform eines Phasenwechselspeichers
20	43	vertikale Ausdehnung
	45	laterale Ausdehnung
	47	erster elektrischer Kontakt
	49	Speichermaterialschicht
	51	zweiter elektrischer Kontakt
	53	Passivierung
	55	Keimbildungsbereich
	57	ZnS:SiO ₂ Schicht
	59	Silizium-Wärme-Senke
	61	Schaltbereich
30	63	Stromführung
	65	Verengung
	67	Abmessung
	69	Abmessung
35	71	zweite bevorzugte Ausführungsform eines Phasenwechselspeichers
	73	erster elektrischer Kontakt
	75	zweiter elektrischer Kontakt

	77	modifizierte Stromführung
	79	thermischer Abstand
	81	weitere bevorzugte Ausführungsform eines
5		Phasenwechselspeichers Phasenwechselspeicher
	83	laterale Ausdehnung
	85	vertikale Ausdehnung
	87	Siliziumsubstrat
	89	MESA-Struktur
10	91	Wärmeleitungsschicht
	93	Speichermaterialschicht
	95	Passivierungsschicht
	97	elektrische Kontakte
	101	Phasenwechselspeicher
15	103	MESA-Struktur
	105	Substrat
	107	Wärmeleitungsschicht
	109	Speichermaterialschicht
	111	elektrisch leitende Schicht
20	113	Graben
	115	elektrische Kontakte
	117	Ätztiefe
	119	Schaltbereich
	123	Passivierung
	131	Phasenwechselspeicheranordnung
	133	erster Phasenwechselspeicher
	135	zweiter Phasenwechselspeicher
	137	dritter Phasenwechselspeicher
	139, 141, 143	elektrischer Kontakt
30	145	Pad
	147	Masse
	149, 151, 153	elektrischer Kontakt
	155, 157, 159	Pad
	161	Phasenwechselspeicher
35	162	Phasenwechselspeicher
	163	erster elektrischer Kontakt
	165	CMOS-Steuertransistor

	167	Phasenwechselspeicherzelle
	169	Siliziumsubstrat
	171	Passivierung
	173	Schaltkontakt
5		
	175	zweiter elektrischer Kontakt
	177	Schaltbereich
	179	Speichermaterialschicht
	181	Wärmesenke
10	183	Isolationsschicht
	185	Masseanschluss
	187	Phasenwechselspeicherzelle
	191	Diode
	201	2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array
15	203	adressierbare Phasenwechselspeicherzellen
	205	Transistor
	207	Phasenwechselspeicher
	211	3D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array
	213	2D-Phasenwechselspeicher-Zellen-Array
20	215	Phasenwechselspeicher
	217	Auswahltransistor
	219	Via
	221	Massepotenzial
	223	Speicher- und/oder Logikfunktion
	225	Elektronikbaustein
	227	anwendungsbezogener Baustein (Embedded Device)
30	D	Dicke

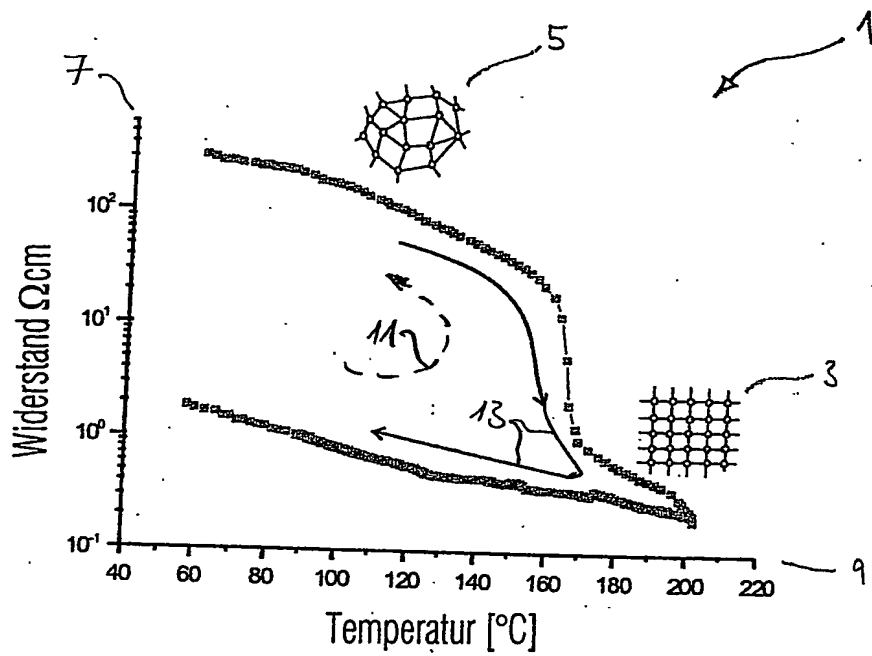


Fig. 1

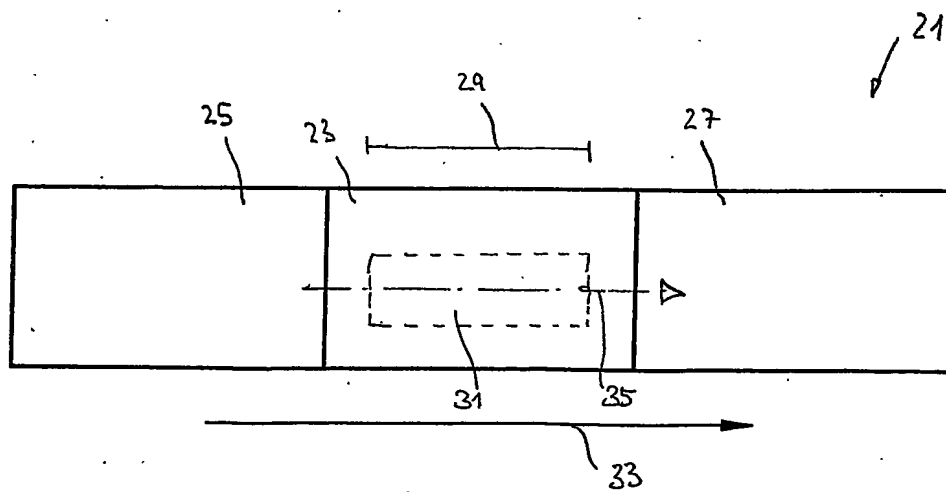


Fig. 2

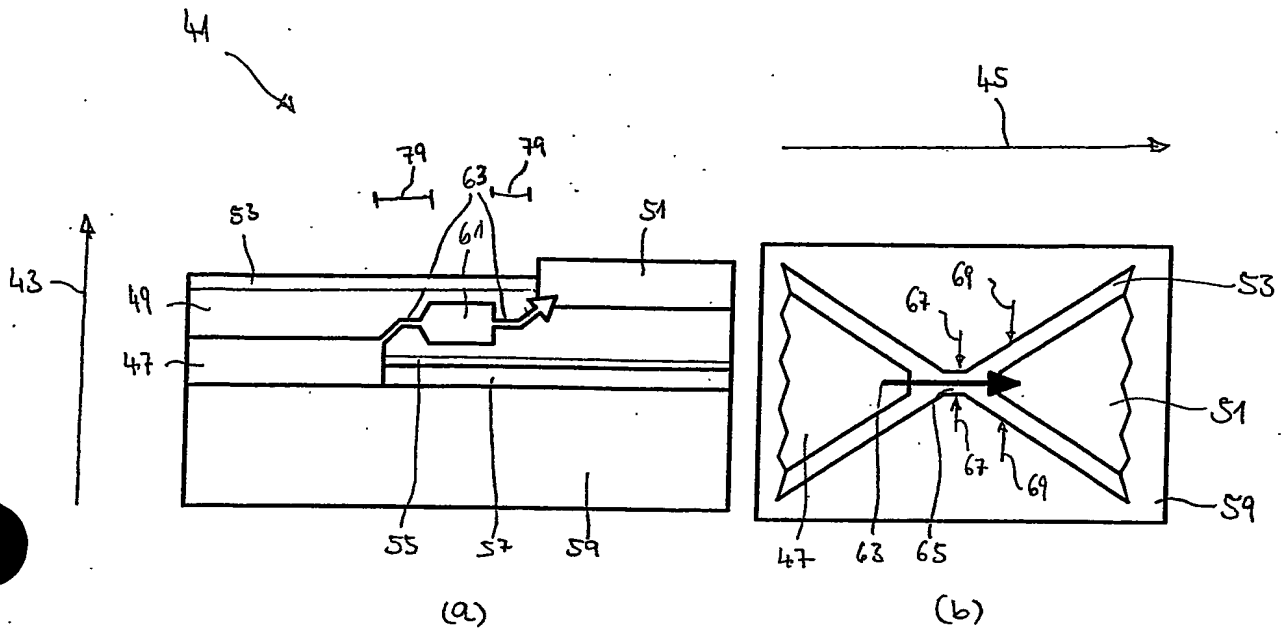


Fig. 3

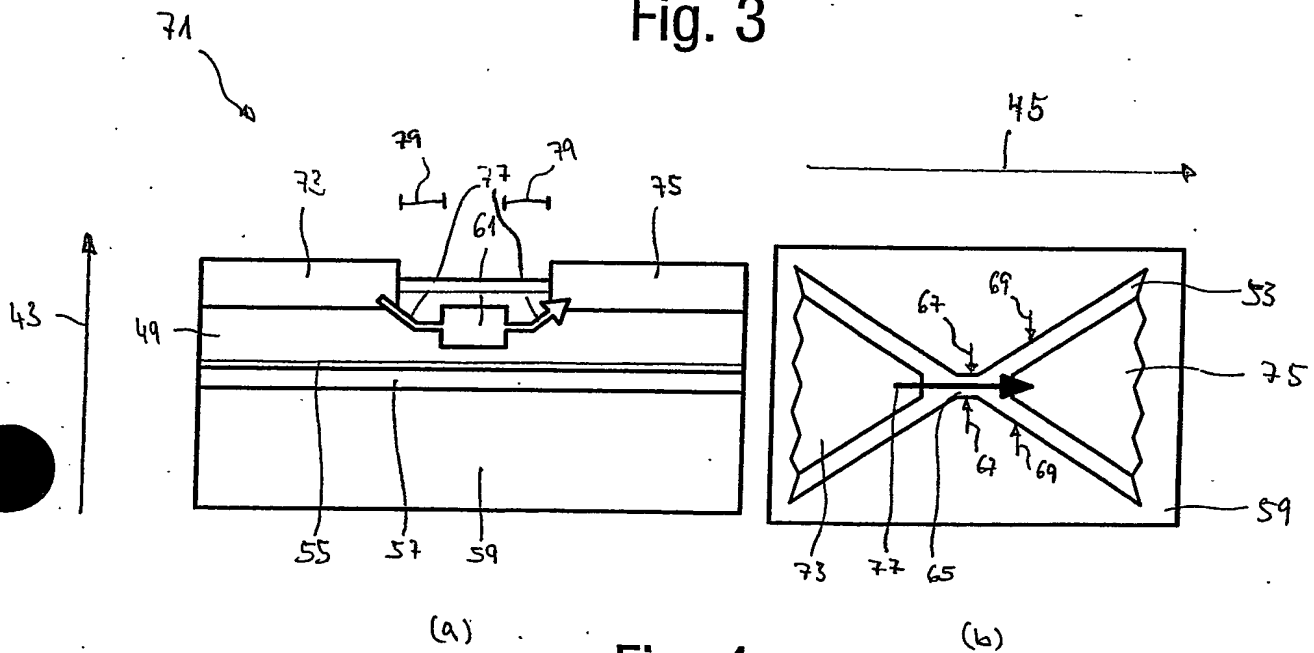


Fig. 4

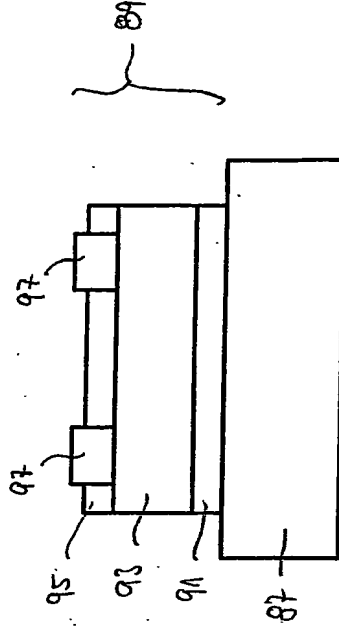
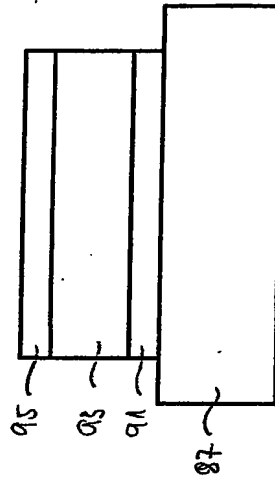
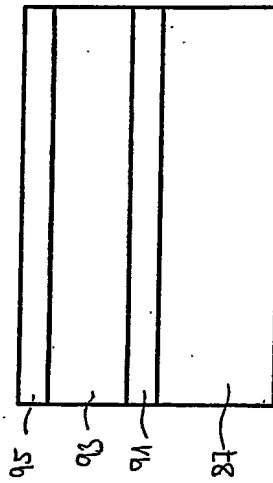
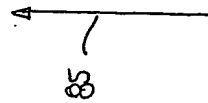
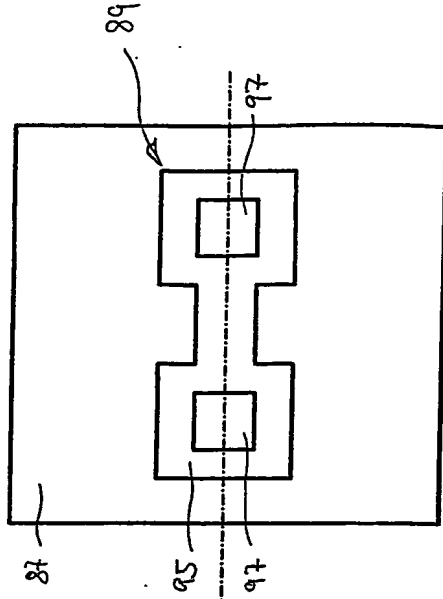
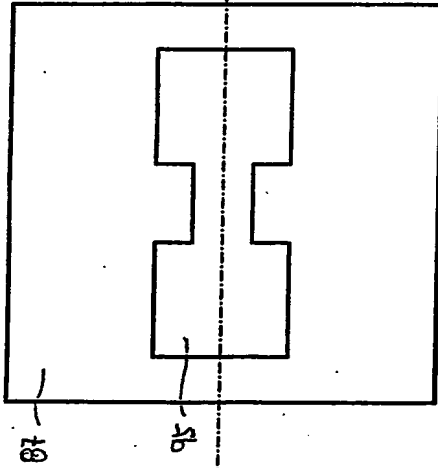
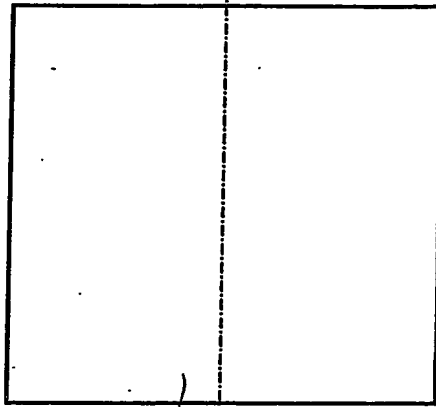


Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5c

B3

A

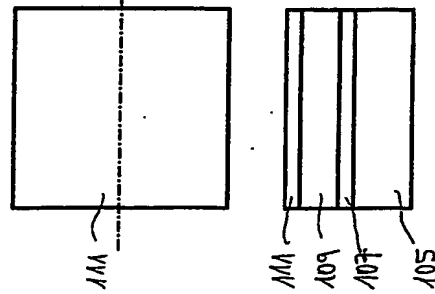


Fig. 6a

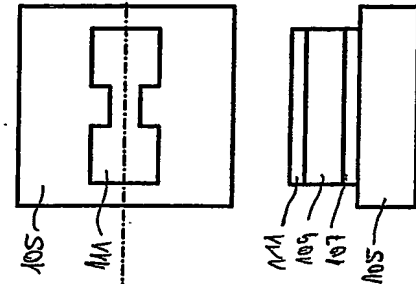


Fig. 6b

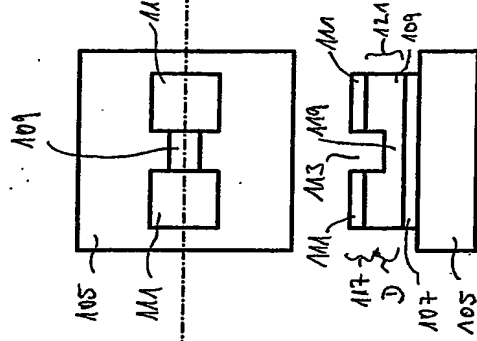


Fig. 6c

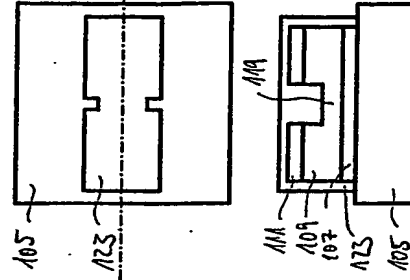


Fig. 6d

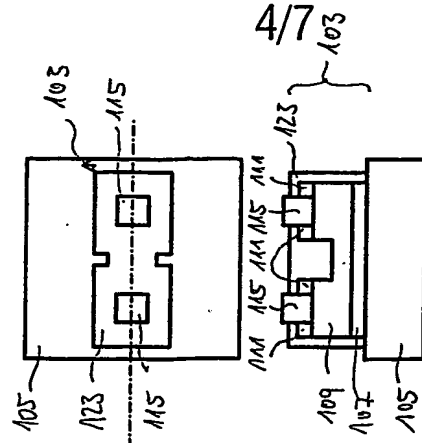


Fig. 6e

4/7

5/7

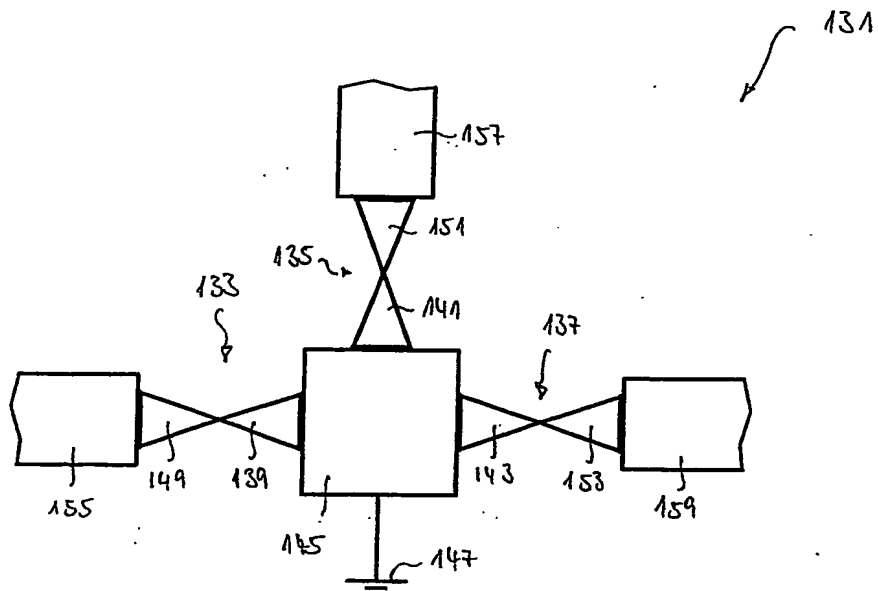


Fig. 7

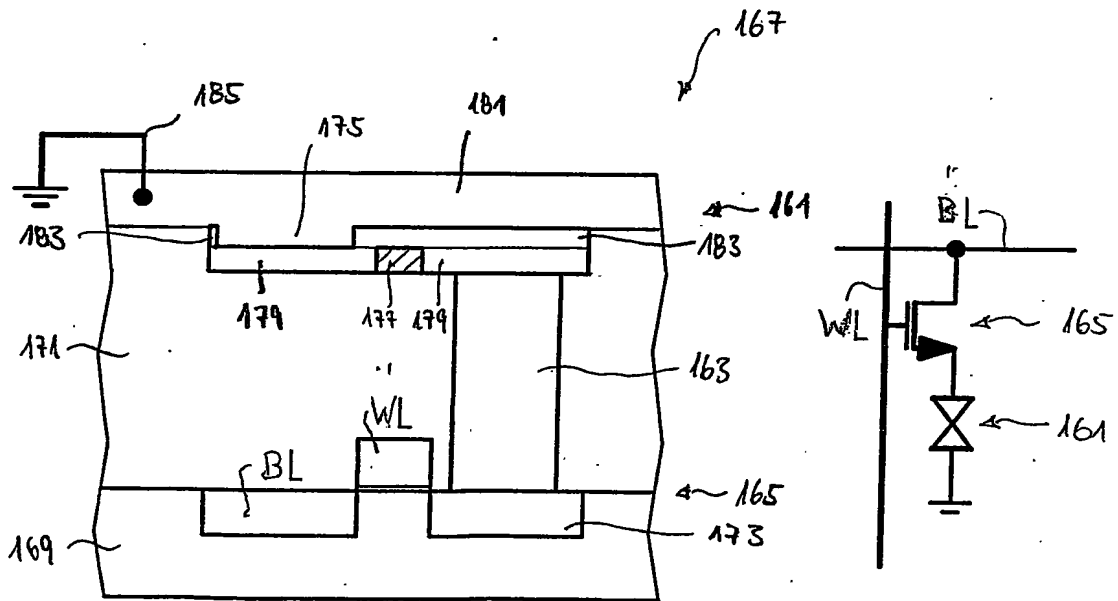


Fig. 8

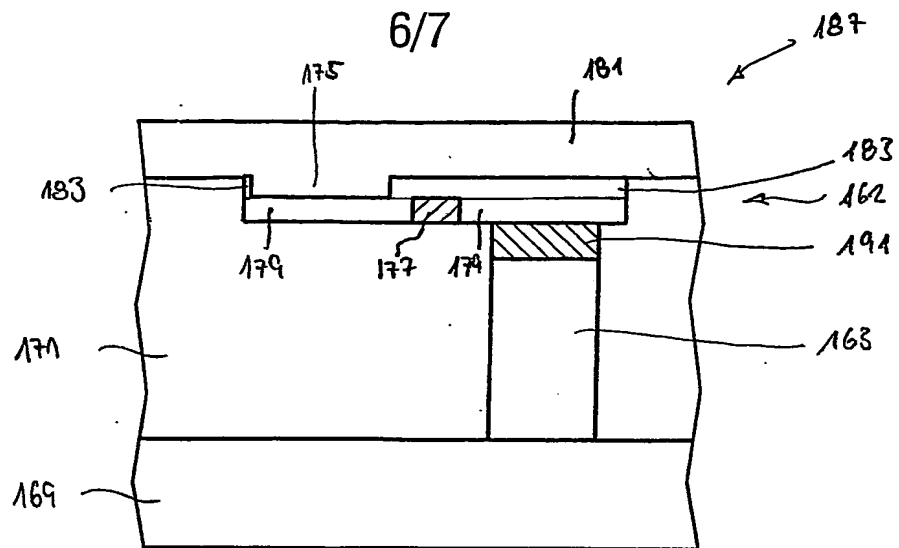


Fig. 9

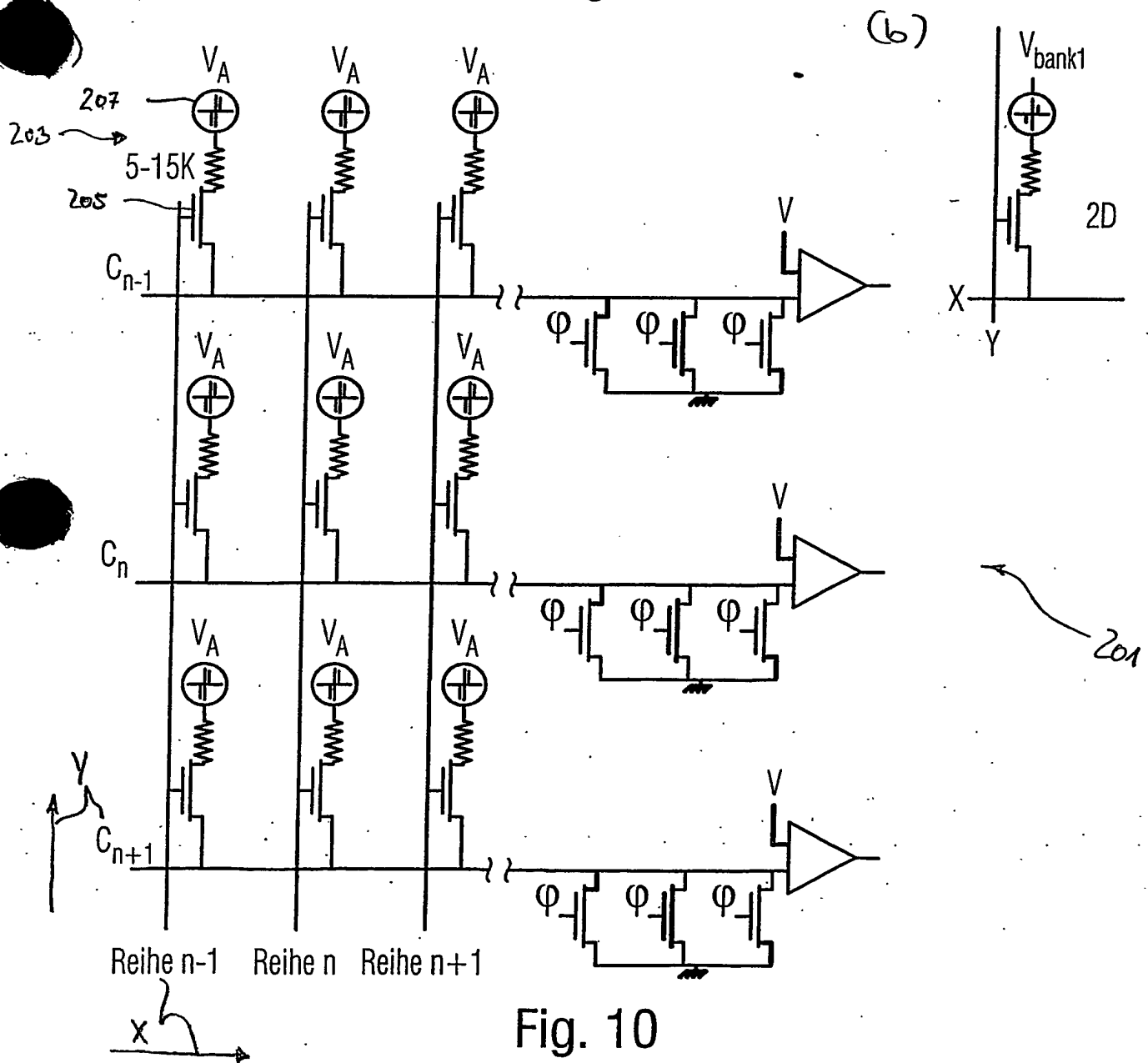


Fig. 10

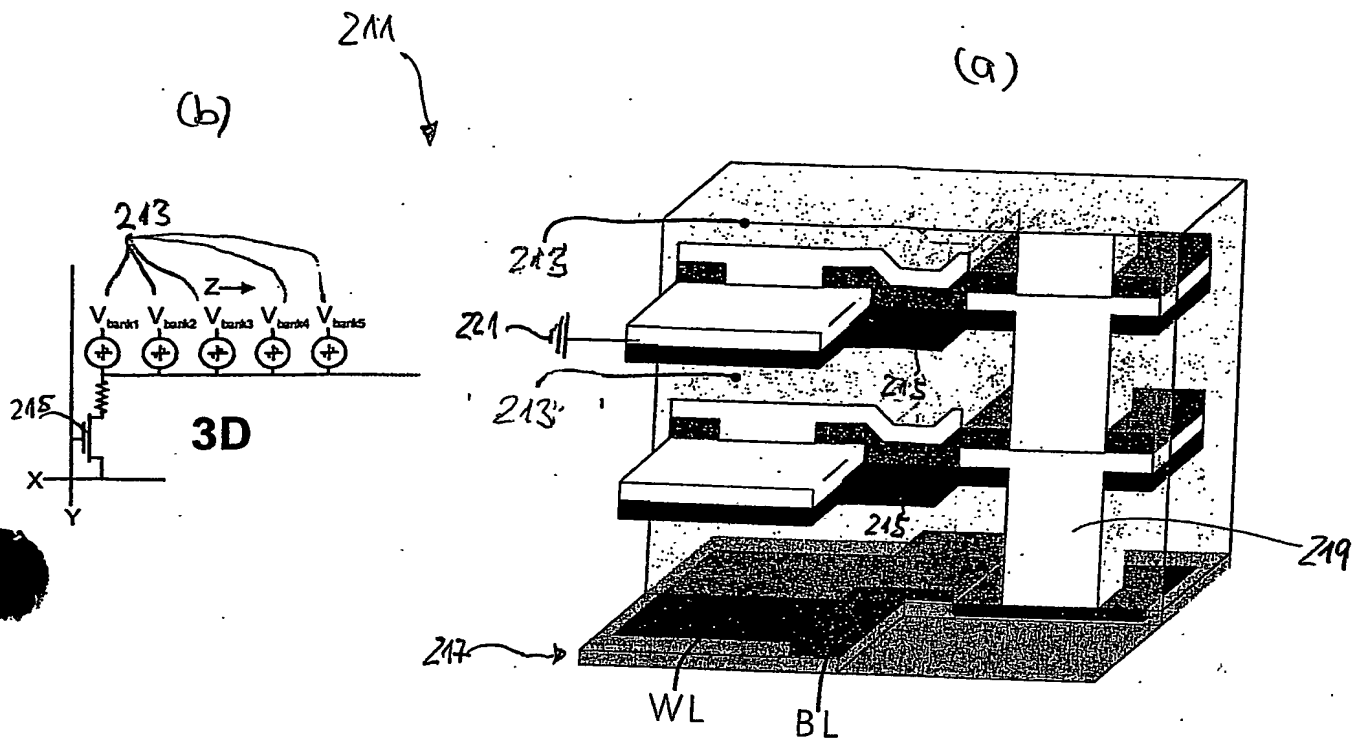


Fig. 11

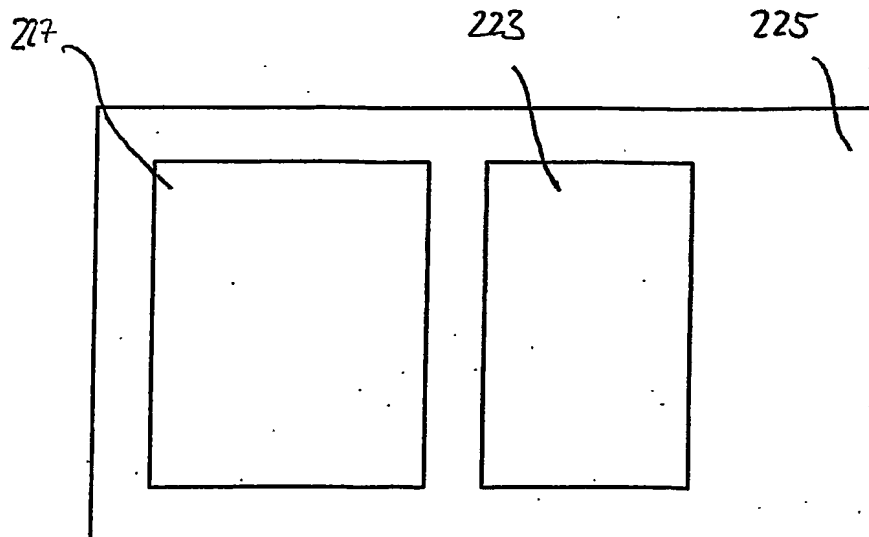


Fig. 12